(19)【発行国】日本国特許庁 (JP)	(19) [Publication Office] Japanese Patent Office (JP) 013004
(12)【公報種別】公開特許公報 (A)	(12) [Kind of Document] Japan Unexamined Patent Publication (A)
(11)【公開番号】特開平11-97180	(11) [Publication Number of Unexamined Application] Japan U nexamined Patent Publication Hei 11 - 97180
(43)【公開日】平成11年(1999)4月9日	(43) [Publication Date of Unexamined Application] 1999 (199 9) April 9 day
(54) 【発明の名称】有機電界発光素子	(54) [Title of Invention] ORGANIC ELECTROLUMINESCEN
(51) 【国際特許分類第6版】	T ELEMENT (51) [International Patent Classification 6th Edition]
H05B 33/14	H05B 33/14
C09K 11/06	C09K 11/06
H05B 33/22	H05B 33/22
[FI]	[FI]
H05B 33/14 B	H05B 33/14 B
C09K 11/06 Z	C09K 11/06 Z
H05B 33/22 B	H05B 33/22 B
D	D
【審査請求】未請求	[Request for Examination] Examination not requested
【請求項の数】6	[Number of Claims] 6
【出願形態】OL	[Form of Application] OL
【全頁数】 1 9	[Number of Pages in Document] 19
(21)【出願番号】特願平9-258971	(21) [Application Number] Japan Patent Application Hei 9 - 25 8971
(22)【出願日】平成9年(1997)9月24日	(22) [Application Date] 1997 (1997) September 24 day
(71) 【出願人】	(71) [Applicant]
【識別番号】00005887	[Applicant Code] 000005887
【氏名又は名称】三井化学株式会社	[Name] MITSUI CHEMICALS INC. (DB 69-056-7037)
【住所又は居所】東京都千代田区霞が関三丁目2番5号	[Address] Tokyo Chiyoda-ku Kasumigaseki 3-Chome 2-5

JP 99097180A Machine Translation

(72) 【発明者】

【氏名】西本 泰三

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】三沢 伝美

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72)【発明者】

【氏名】杉本 賢一

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】塚原 宇

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】詫摩 啓輔

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井東圧化学株式会社内

(72) 【発明者】

【氏名】中塚 正勝

【住所又は居所】神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 (57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、ベンゾピロメテン系化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【効果】 発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供する。

(72) [Inventor]

[Name] Nishimoto Taizo

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Misawa transmission beauty

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Sugimoto Kenichi

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 1190 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Tsukahara space/large house

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Takuma Keisuke

[Address] Inside of Kanagawa Prefecture Yokohama City Sakaeku Kasama-cho 119 0 Mitsui Toatsu Chemicals Inc. (DB 69-053-6982)

(72) [Inventor]

[Name] Nakatsuka Masakatsu

(57) [Abstract]

[Means of Solution] Between pair of electrodes, at least one la yer clamping doing layer which at least 1 kind contains, the benzo pyro methene compound, organic electroluminescent element which becomes.

[Effect(s)] Organic electroluminescent element where light emission luminance is superior is offered.

【特許請求の笕囲】

【 請求項 1 】 一対の電極間に、下記一般式 (1) (化1)で 設される化合物を少なくとも 1 種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【化1】|

〔式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_8 gはそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アリールオキシ基 、アシル基、アルコキシカルポニル基、ジアルキルアミノカ ルポニル基、アルキルカルポニルアミノ基、アリールカルボ ニルアミノ基、アリールアミノカルボニル基、アリールオキ シカルボニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素 環式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケ ニルオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、 アルコキシカルポニルアルコキシカルボニル基、アルキルカ ルボニルアルコキシカルボニル基、ジ(アルコキシアルキル) アミノカルボニル基、またはアルケニル基を表し、Raは 水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式 アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を衰 し、R10およびR11はフッ素原子、アルキル基、アルコキシ 基、アラルキル基、炭素環式アリール基、または複素環式ア リール基を表す]

【 請求項2 】 一般式(1)で衰される化合物を含有する
が、発光層である請求項1 記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 一般式(1)で寂される化合物を含有する層が、電子注入輸送層である諳求項1記鼓の有機電界発光素子

【請求項4】 一般式(1)で衰される化合物を含有する層

[Claim(s)]

[Claim 1] Between pair of electrodes, at least one layer clamping doing layer which at least 1 kind contains, the compound which is displayed with below-mentioned General Formula (1) (Chemical formula 1), organic electroluminescent element which becomes.

[Chemical Formula 1]

(The inside of Formula, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, A s for R9 to respective independence, hydrogen atom, halogen atom, cyano group, alkyl group, halogeno alkyl group, alkoxy alkył group, alkoxy group, alkoxy group, aryloxy group, acyl group, alkoxy carbonyl group, dialkyl amino carbonyl group, alkyl carbonyl amino group, aryl carbonyl amino group, aryl amino carbonyl group, aryloxy carbonyl group, aralkyl group, the carbocyclic aryl group, heterocyclic aryl group, alkyl thio group, aryl thio group, alkenyl oxycarbonyl group, aralkyloxy carbonyl group, the alkoxy carbonyl alkoxy carbonyl group, alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group, di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group or alkenyl group are displayed, R4displays hydrogen atom, cyano group, alkyl group, aralkyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group or alkenyl group, R10 and R11 displays fluorine atom, alkyl group, the alkoxy group, aralkyl group, carbocyclic aryl group or heterocyclic aryl group)

[Claim 2] Layer which contains compound which is displayed with General Formula (1), the organic electroluminescent element which is stated in Claim 1 which is a luminescent layer.

[Claim 3] Layer which contains compound which is displayed with General Formula (1), the organic electroluminescent element which is stated in Claim 1 which is a electronimplanted transport layer.

[Claim 4] Layer which contains compound which is displayed

が、さらに発光性有機金属錯体を含有する請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を 有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を 有する請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バック ライトなどのパネル型光源として使用されてきたが、該発光 素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要である。最近に なり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機 エレクトロルミネッセンス素子: 有機EL素子) が開発され た [Appl. Phys. Lett., 51 、913 (1987)] 。有機電界発 光素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に 挟持された構造を有し、該薄膜に電子および正孔(ホール) を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン) を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用 して発光する素子である。有機電界発光素子は、数V~数十 V程度の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有 機化合物の種類を選択することにより、種々の色(例えば、 赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を 有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等へ の応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光輝度 が低く、実用上充分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層として、例えば、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムをホスト化合物とし、クマリン誘導体、ピラン誘導体をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発光素子が提案されている【J. Appl. Phys., 65、3610(1989)】。また、発光層として、トリス(8ーキノリノラート)アルミニ

with General Formula (1), furthermore organic electroluminescent element which is stated in any of Claim 1 to 3 whichcontains luminescent organometallic complex.

[Claim 5] Between pair of electrodes, furthermore, organic electroluminescent element which is stated in any of Claims 1 through 4 which possesses positive hole injection transport layer.

[Claim 6] Between pair of electrodes, furthermore, organic electroluminescent element which is stated in any of Claims 1 through 5 which possesses electron-implanted transport layer.

[Description of the Invention]

[0001]

[Technological Field of Invention] This invention regards organic electroluminescent element.

[0002]

[Prior Art] Until recently, inorganic electroluminescent elemen t was used as for example backlight or other panel type light source, but the said luminescent element is driven, high voltage of alternating current is necessary. Recent, organic electroluminescent element (organic electroluminescent element: organic electroluminescent element) which uses organic material for light-emitting material was developed(Applied Physics Letters, 51 and 913 (1987)). organic electroluminescent element, thin film which includes fluorescence organic compound, having structure whichthe clamping is done between anode and cathode, filling electronand positive hole (hole) in said thin film, forming exciton (エキシ ton) by recombination doing when this exciton inactivation doing, it is a element which light emitting is donemaking use of light which is discharged. As for organic electroluminescent element, with low voltage of direct current of several V to several tens V extent, light emitting is possible, light emitting of various color (for example red color, blue and green color) is possible by inaddition selecting types of fluorescence organic compound. As for organic electroluminescent element which possesses this kind of feature. application to the various luminescent element and display element etc is expected. But, generally, light emitting brightness is low, in regard to utility it is not asatisfactory.

[0003] for example tris (8 - quinolinolato) aluminum is designated as host compound light emitting brightness as method whichimproves, as luminescent layer, organic electroluminescent element which uses coumarin derivative and pyran derivativeas guest compound (dopant) is proposed (Journal of Applied Physics (0021-8979, JAPIAU), 65, 3610

・ウムをホスト化合物とし、ピロメテン誘導体(例えば、1、3、5、7、8ーペンタメチルー4、4ージフルオロー4ーポラー3a、4aージアザーsーインダセン)をゲスト化合物として用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平9ー118880号公報)。しかしながら、該公報に記載されているピロメテン誘導体を使用すると、発光色はは記いことが判明した。さらには、特開平9ー118880号いことが判明した。さらには、特開平9ー118880号いことが判明した。さらには、特開平9ー118880号いことが判明した。さらには、特開平9ー118880号いことが判明した。プースプースの密着性は乏しく、長期間の使用に、役のは、に、その改良が必要であることが判明した。現在では、その改良が必要であることが判明した。現在では、その改良が必要であることが判明した。現在では、その改良が必要であることが判明した。現在では、その改良が必要であることが判明した。現在では、その改良が必要であることが判明した。現在では、投色ないし赤色に発光し、且つ、高輝度に発光する有機電界発光素子が望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光索子を提供することである。|

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界発光 素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成するに至った 。すなわち、本発明は、

一対の電極間に、下記一般式(1)(化2)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光層である記載の有機電界発光素子、

一般式(1)で表される化合物を含有する層が、電子注入 輸送層である記載の有機電界発光素子、

一般式(1)で褒される化合物を含有する層が、さらに発 光性有機金属錯体を含有する前配~のいずれかに記載の有機 電界発光素子、

(1989)). In addition, tris (8 - quinolinolato) aluminum is designated as host compound as luminescent layer, theorganic electroluminescent element which uses pyro methene derivative (for example 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4, 4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza - s - indacene) as guest compound is proposed, (Japan Unexamined Patent Publication Hei 9-118880 disclosure). But, when pyro methene derivative which is stated in said disclosure is used, emission colorwas green or yellow green, in addition has possessed satisfactory light emitting brightness withit is difficult saving was ascertained. Furthermore, adhesion of layer and electrode (for example cathode) which contain pyro methene derivative (for example 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4, 4-di fluoro - 4 bora - 3a,4a-di aza - s - indacene) which is stated in Japan Unexamined Patent Publication Hei 9 - 118880 disclosure is scanty, improvement beingnecessary at time of use of long period, was ascertained. Presently, light emitting it does in amber color or red color, organic electroluminescent elementwhich light emitting is done is desired to and high brightness.

[0004]

[Problems to be Solved by the Invention] Problem of this invention is superior in light emission efficiency, it is to offer theorganic electroluminescent element which light emitting is done in high brightness.

[0005]

[Means to Solve the Problems] This inventor etc, result of dilig ent investigation, this invention reached to completion inregard to organic electroluminescent element. As for namely, this invention,

Between pair of electrodes, at least one layer clamping doing 1 ayer which at least 1 kind contains, the compound which is displayed with below-mentioned General Formula (1) (Chemical formula 2), organic electroluminescent element which becomes,

Layer which contains compound which is displayed with Gener al Formula (1), is luminescent layer organic electroluminescent element which is stated,

Layer which contains compound which is displayed with Gener al Formula (1), is electron-implanted transport layer organic electroluminescent element which is stated,

Layer which contains compound which is displayed with Gener al Formula (1), furthermore organic electroluminescent element which is stated in any of theaforementioned to which contains luminescent organometallic complex,

一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、

一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである

[0006]

【化2】|

$$R_{10}$$
 R_{10}
 R_{10}
 R_{11}
 R_{11}
 R_{12}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{15}
 R_{15}

〔式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_8 gはそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシアルキル基、 アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、アリールオキシ基 、アシル基、アルコキシカルボニル基、ジアルキルアミノカ ルポニル基、アルキルカルボニルアミノ基、アリールカルボ ニルアミノ基、アリールアミノカルボニル基、アリールオキ シカルポニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素 環式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケ ニルオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、 アルコキシカルポニルアルコキシカルボニル基、アルキルカ ルボニルアルコキシカルボニル基、ジ(アルコキシアルキル) アミノカルポニル基、またはアルケニル基を表し、Raは 水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式 アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を表。 し、R₁₀およびR₁₁はフッ素原子、アルキル基、アルコキシ 基、アラルキル基、炭素環式アリール基、または複素環式ア リール基を表す】

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、前配一般式 (1) で表されるペンゾピロメテン系化合物を少なくとも 1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなるものである。前配一般式 (1) で表されるペンゾピロメテン系化合物において、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R_9 はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アリールオキシ基、アリールオキシ基、アリールオキシ基

Between pair of electrodes, furthermore, organic electrolumin escent element which is stated in any of aforementioned to which possesses positive hole injection transport layer,

Between pair of electrodes, furthermore, organic electrolumin escent element which is stated in any of aforementioned to which possesses electron-implanted transport layer, it is somethingregarding.

[0006]

[Chemical Formula 2]

(The inside of Formula, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, A s for R9 to respective independence, hydrogen atom, halogen atom, cyano group, alkyl group, halogeno alkyl group, alkoxy alkył group, alkoxy group, alkoxy group, aryloxy group, acyl group, alkoxy carbonyl group, dialkyl amino carbonyl group, alkyl carbonyl amino group, aryl carbonyl amino group, aryl amino carbonyl group, aryloxy carbonyl group, aralkyl group, the carbocyclic aryl group, heterocyclic aryl group, alkyl thio group, aryl thio group, alkenyl oxycarbonyl group, aralkyloxy carbonyl group, the alkoxy carbonyl alkoxy carbonyl group, alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group, di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group or alkenyl group are displayed, R4displays hydrogen atom, cyano group, alkyl group, aralkyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group or alkenyl group, R10 and R11 displays fluorine atom, alkyl group, the alkoxy group, aralkyl group, carbocyclic aryl group or heterocyclic aryl group)

[0007]

[Embodiment of Invention] You explain in detail below, in regard to this invention. organic electroluminescent element of this invention, between pair of electrodes, at least one layer clamping doing layerwhich at least 1 kind contains, benzo pyro methene compound which is displayed with theaforementioned General Formula (1), is something which becomes. In benzo pyro methene compound which is displayed with aforementioned General Formula (1)putting, R1, R2, R3, R5, R6, R7, R8, As for R9 to respective independence,

、アシル基、アルコキシカルボニル基、ジアルキルアミノカルボニル基、アルキルカルボニルアミノ基、アリールカルボニルアミノ基、アリールオキシカルボニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アルケニルオキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アルコキシカルボニルアルコキシカルボニルアルコキシカルボニルアルコキシカルボニルアルコキシカルボニルアルコキシカルボニルアルコキシカルボニルを表し、好ましくは、水素原子、アルキル基、炭素環式アリール基を表す。

【0008】 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 および R_9 の具体例としては、水素原子:フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素のハロゲン原子;シアノ基;例えば、メチル基、 エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、i so-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、 iso-ペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、n eo-ペンチル基、1,2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプ ロピル基、cyclo-ペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペン チル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチ ルペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチルブチル 基、1,3-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、1,2-ジ メチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチルブチル基 、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1, 2, 2-トリメチル ブチル基、1.1.2-トリメチルブチル基、1-エチル-2- メチル プロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘ キシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル基、5-メ チルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチル基、n-オクチル基、 2-エチルヘキシル基、2,5-ジメチルヘキシル基、2,5,5-トリ メチルペンチル基、2,4-ジメチルヘキシル基、2,2,4-トリメ チルペンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基 、ハーデシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4,5- ジメチ ルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1.3.5.7-テ トラメチルオクチル基、4-ブチルオクチル基、6,6-ジェチル オクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブチルオクチル 基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3,5-ジメチルへ プチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジメチルヘプチル 基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-cyclo-ペンチル -2,2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシル-2,2- ジメ チルプロピル基等の直鎖、分岐または環状のアルキル基:

【0009】例えば、クロロメチル基、ジクロロメチル基、フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタフルオロメチル基、ノナフルオロブチル基等のハロゲノアルキル基:例えば、メトキシエチル基、エトキシエチル基、iso-プロビルオキシエチル基、3-メトキシプ

hydrogen atom, halogen atom, cyano group, alkyl group, halogeno alkyl group, alkoxy alkyl group, the alkoxy group, alkoxy group, acyl group, alkoxy carbonyl group, dialkyl amino carbonyl group, the alkyl carbonyl amino group, aryl carbonyl amino group, aryl carbonyl group, aryl amino carbonyl group, aryloxy carbonyl group, aralkyl group, carbocyclic aryl group, the heterocyclic aryl group, alkyl thio group, aryl thio group, alkenyl oxycarbonyl group, aralkyloxy carbonyl group, alkoxy carbonyl group, the alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group, the alkyl carbonyl group or alkenyl group are displayed, preferably, hydrogen atom, the alkyl group and carbocyclic aryl group are displayed.

[0008] As embodiment of R1, R2, R3, R5, R6, the R7 and R8 and R9, hydrogen atom; halogen atom of fluorine, chlorine, bromine and iodine; cyano group; for example methyl group, ethyl group, n-propyl group, iso-propyl group, n-butyl group, iso-butyl group, s-butyl group, tbutyl group, n-pentyl group, iso-pentyl group, 2-methyl butyl group, 1- methyl butyl group, neo- pentyl group, 1, 2dimethyl propyl group, 1, 1-dimethyl propyl group, cyc lopentyl group, n-hexyl group, 4- methyl pentyl group, 3methyl pentyl group, 2-methyl pentyl group, 1-methyl pentyl group, 3, 3-dimethylbutyl group, 2, 3-dimethylbutyl group, 1, 3- dimethylbutyl group, 2, 2- dimethylbutyl group, 1, 2- dimethylbutyl group, 1, 1- dimethylbutyl group, 3- ethyl butyl group, 2- ethyl butyl group, 1- ethyl butyl group, 1,2,2trimethyl butyl group, 1,1, 2- trimethyl butyl group, alkyl group of 1- ethyl-2- methyl propyl group, cyc lo-hexyl group, n-heptyl group, 2-methyl hexyl group, 3-methyl hexyl group, 4- methyl hexyl group, 5- methyl hexyl group, 2, 4- dimethyl pentyl group, n- octyl group, 2- ethylhexyl group, 2,5-dimethyl hexyl group, 2,5,5-trimethyl pentyl group, 2, 4- dimethyl hexyl group, 2,2, 4- trimethyl pentyl group, n-nonyl group, 3,5,5- trimethyl hexyl group, ndecyl group, 4- ethyl octyl group, 4- ethyl-4,5- dimethyl hexyl group, n-undecyl group, n-dodecyl group, 1,3,5,7tetramethyl octyl group, 4-butyl octyl group, 6,6-diethyl octyl group, n-tridecyl group, 6-methyl-4- butyl octyl group, n-tetradecyl group, n-pentadecyl group, 3,5dimethyl heptyl group, 2,6-dimethyl heptyl group, 2,4dimethyl heptyl group, 2,2,5,5- tetramethyl hexyl group, 1cyc lo- pentyl-2, 2- dimethyl propyl group, 1- cyc lo- hexyl-2, 2- dimethyl propyl group or other straight chain and branched or cyclic;

[0009] For example chloromethyl group, dichloro methyl group, fluoromethyl group, trifluoromethyl group, penta fluoromethyl group, pentafluoroethyl group and nonafluorobutyl group or other halogeno alkyl group; for example methoxyethyl group, ethoxyethyl group, iso-propyl

ロビル基、2-メトキシブチル基等のアルコキシアルキル基: 例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキシ基、iso-プ ロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-ブトキシ基、sec-ブトキシ 基、t-ブトキシ基、n-ペントキシ基、iso-ペントキシ基、n eo-ペントキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n ードデシルオキ シ基等のアルコキシ基;例えば、メトキシエトキシ基、エト キシエトキシ基、3-メトキシプロピルオキシ基、3-(iso-プ ロピルオキシ)プロピルオキシ基等のアルコキシアルコキシ 基:例えば、フェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、4-メチ ルフェノキシ基、4-t-ブチルフェノキシ基、2-メトキシフェ ノキシ基、4-iso-プロピルフェノキシ基等のアリールオキシ 基:例えば、ホルミル基、アセチル基、エチルカルポニル基、 n-プロピルカルボニル基、iso-プロピルカルボニル基、n-ブ チルカルポニル基、iso-ブチルカルポニル基、sec-ブチルカ ルポニル基、t-ブチルカルポニル基、n-ペンチルカルポニル 基、iso-ペンチルカルボニル基、neo-ペンチルカルボニル基 、2-メチルブチルカルボニル基、ニトロペンジルカルボニル 基等のアシル基:例えば、メトキシカルポニル基、エトキシ カルポニル基、イソプロピルオキシカルポニル基、2,4-ジメ チルプチルオキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基

【0010】例えば、ジメチルアミノカルボニル基、ジエチ ルアミノカルボニル基、ジ-n- プロピルアミノカルボニル基 、ジ-n- ブチルアミノカルボニル基、N-メチル-N- シクロヘ キシルアミノカルボニル基等のジアルキルアミノカルボニル 基:例えば、アセチルアミノ基、エチルカルボニルアミノ基 ブチルカルポニルアミノ基等のアルキルカルポニルアミノ 基:例えば、フェニルアミノカルポニル基、4-メチルフェニ ルアミノカルボニル基、2-メトキシフェニルアミノカルボニ ル基、4-n-プロピルフェニルアミノカルボニル基等のアリー ルアミノカルボニル基:例えば、フェニルカルボニルアミノ基 、4-エチルフェニルカルポニルアミノ基、3-ブチルフェニル カルポニルアミノ基等のアリールカルポニルアミノ基:例えば 、フェノキシカルポニル基、2-メチルフェノキシカルポニル 基、4-メトキシフェノキシカルポニル基、4-t-プチルフェノ キシカルボニル基等のアリールオキシカルボニル基:例えば、 ペンジル基、ニトロペンジル基、シアノペンジル基、ヒドロ キシペンジル基、メチルペンジル基、ジメチルペンジル基、 トリメチルベンジル基、ジクロロベンジル基、メトキシベン ジル基、エトキシベンジル基、トリフルオロメチルベンジル 基、ナフチルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナ フチルメチル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフ チルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基等のア ラルキル基:

【0011】例えば、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニル基、 ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、ジクロロフェ ニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、トリフ ルオロメチルフェニル基、N.N-ジメチルアミノフェニル基、

oxyethyl group, 3-methoxypropyl group, 2-methoxybutyl group or other alkoxy alkyl group; for example methoxy group, ethoxy group, n-propoxy group, iso-propoxy group, n-butoxy group, iso-butoxy group, s-butoxy group, tbutoxy group, n-pentoxy group, iso-pentoxy group, neopentoxy group, n-hexyloxy group and n-dodecyl oxy group or other alkoxy group; for example methoxy ethoxy group, ethoxy ethoxy group, 3-methoxypropyl oxy group and 3-(iso-propyl oxy) propyl oxy group or other alkoxy alkoxy group; for example phenoxy group, 2- methyl phenoxy group, 4- methyl phenoxy group, 4- t-butyl phenoxy group, 2- methoxy phenoxy group, 4- iso- propyl phenoxy group or other aryloxy group; for example formyl group, acetyl group, ethyl carbonyl group, n-propyl carbonyl group, iso-propyl carbonyl group, n-butyl carbonyl group, iso-butyl carbonyl group, s-butyl carbonyl group, t-butyl carbonyl group, npentyl carbonyl group, iso-pentyl carbonyl group, neo-pentyl carbonyl group, 2- methyl butyl carbonyl group and nitrobenzyl carbonyl group or other acyl group; for example methoxycarbonyl group, ethoxy carbonyl group, isopropyl oxycarbonyl group and 2, 4- dimethylbutyl oxycarbonyl group or other alkoxy carbonyl group;

[0010] For example dimethylamino carbonyl group, diethyl a mino carbonyl group, di-n-propylamino carbonyl group, di-nbutyl amino carbonyl group and N- methyl- N- cyclohexyl amino carbonyl group or other dialkyl amino carbonyl group; for example acetylamino group, ethyl carbonyl amino group and butyl carbonyl amino group or other alkyl carbonyl amino group; for example phenylamino carbonyl group. 4methylphenyl amino carbonyl group, 2- methoxyphenyl amino carbonyl group, 4- n- propyl phenylamino carbonyl group or other aryl amino carbonyl group; for example phenyl carbonyl amino group, 4- ethyl phenyl carbonyl amino group, 3- butyl phenyl carbonyl amino group or other aryl carbonyl amino group; for example phenoxy carbonyl group, 2methyl phenoxy carbonyl group, 4- methoxy phenoxy carbonyl group, 4- t-butyl phenoxy carbonyl group or other aryloxy carbonyl group; for example benzyl group, nitrobenzyl group, cyano benzyl group, hydroxy benzyl group, methylbenzyl group, dimethyl benzyl group, trimethyl benzyl group, dichloro benzyl group, methoxy benzyl group, ethoxy benzyl group, trifluoromethyl benzyl group, naphthyl methyl group, nitro naphthyl methyl group, cyano naphthyl methyl group, hydroxy naphthyl methyl group, methyl naphthyl methyl group and trifluoromethyl naphthyl methyl group or other aralkyl group;

[0011] For example phenyl group, nitrophenyl group, cyano phenyl group, hydroxyphenyl group, methyl phenyl group, dimethylphenyl group, trimethyl phenyl group, dichlorophenyl group, methoxyphenyl group, ethoxy phenyl group, trifluoromethyl phenyl group, N, N-dimethylamino

ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロ キシナフチル基、メチルナフチル基、トリフルオロメチルナ フチル基等の炭素環式アリール基: 例えば、ピロリル基、チェ ニル基、フラニル基、オキサゾイル基、イソオキサゾイル基 、オキサジアゾイル基、イミダゾイル基、ペンゾオキサゾイ ル基、ペンゾチアゾイル基、ペンゾイミダゾイル基、ペンゾ フラニル基、インドイル基等の複素環式アリール基; 例えば 、メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、iso-プ ロピルチオ基、n-ブチルチオ基、iso-ブチルチオ基、sec-ブ チルチオ基、t-プチルチオ基、n-ペンチルチオ基、iso-ペン チルチオ基、2-メチルブチルチオ基、1-メチルブチルチオ基 、neo-ペンチルチオ基、1,2-ジメチルプロピルチオ基、1,1 -ジメチルプロピルチオ基等のアルキルチオ基;例えば、フェ ニルチオ基、4-メチルフェニルチオ基、2-メトキシフェニル チオ基、4-t-ブチルフェニルチオ基等のアリールチオ基:例 えば、アリルオキシカルポニル基、2-ブテノキシカルポニル 基等のアルケニルオキシカルボニル基:例えば、ベンジルオ キシカルボニル基、フェネチルオキシカルボニル基等のアラ ルキルオキシカルポニル基;

【〇〇12】例えば、メトキシカルポニルメトキシカルポニ ル基、エトキシカルボニルメトキシカルボニル基、n-プロポ キシカルボニルメトキシカルボニル基、イソポウロポキシカ ルポニルメトキシカルポニル基等のアルコキシカルポニルア ルコキシカルボニル基:例えば、メチルカルボニルメトキシ カルボニル基、エチルカルボニルメトキシカルボニル基等の アルキルカルボニルアルコキシカルボニル基;例えば、ジ(メトキシエチル) アミノカルポニル基、ジ (エトキシメチル) アミノカルポニル基、ジ (エトキシエチル) アミノカルボ ニル基、ジ(プロポキシエチル)アミノカルボニル基等のジ (アルコキシアルキル)アミノカルポニル基;例えば、ビニ ル基、プロペニル基、1-ブテニル基、iso-ブテニル基、1-ペ ンテニル基、2-ペンテニル基、2-メチル-1- ブテニル基、3 -メチル-1- ブテニル基、2-メチル-2- ブテニル基、2,2-ジ シアノビニル基、2-シアノ-2- メチルカルボキシルビニル基 、2-シアノ-2- メチルスルホンビニル基等のアルケニル基を 挙げることができる。

【0013】R4 は水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を表し、好ましくは、水素原子、アルキル基を表す。R4 の具体例としては、水素原子;シアノ基;例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、n-ペンチル基、iso-プチル基、n-ペンチル基、iso-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、iso-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチル基、n-ペンチルス・n

phenyl group, naphthyl group, nitro naphthyl group, cyano naphthyl group, hydroxy naphthyl group, methyl naphthyl group, trifluoromethyl naphthyl group or other carbocyclic aryl group; for example pyrrolyl group, thienyl group, furanyl group and ox: y yl group, isoxazoyl basis, oxa diazo yl group, imidazoyl group and benzo ox y yl group, benzo thiazovi group, benzo imidazovi group, benzofuranyi group and India yl group or other heterocyclic aryl group; for example methylthio group, ethyl thio group, n-propyl thio group, iso-propyl thio group, n-butyl thio group, iso-butyl thio group, s-butyl thio group, t-butyl thio group, n-pentyl thio group, iso-pentyl thio group, 2- methyl butyl thio group, 1- methyl butyl thio group, neo-pentyl thio group, 1, 2dimethyl propyl thio group and 1, 1- dimethyl propyl thio group or other alkyl thio group; for example phenylthio group, 4- methylphenyl thio group, 2- methoxyphenyl thio group, 4- t-butyl phenylthio group or other aryl thio group; for example allyl oxycarbonyl group and 2- butenoxy carbonyl group or other alkenyl oxycarbonyl group; for example benzyloxycarbonyl group and phenethyl oxycarbonyl group or other aralkyloxy carbonyl group;

[0012] For example methoxycarbonyl methoxycarbonyl group, ethoxy carbonyl methoxycarbonyl group, n-propoxy carbonyl methoxycarbonyl group and isポウロポキシ carbonyl methoxycarbonyl group or other alkoxy carbonyl alkoxy carbonyl group; the for example methyl carbonyl methoxycarbonyl group and ethyl carbonyl methoxycarbonyl group or other alkyl carbonyl alkoxy carbonyl group; for example di (methoxyethyl) amino carbonyl group, di (ethoxymethyl) amino carbonyl group, di (ethoxyethyl) amino carbonyl group and di (propoxyethyl) amino carbonyl group or other di (alkoxy alkyl) amino carbonyl group; the for example vinyl group, propenyl group, 1-butenyl group, isobutenyl group, 1-pentenyl group, 2-pentenyl group, the 2methyl-1- butenyl group, 3-methyl-1- butenyl group, 2methyl-2- butenyl group, 2, 2- di cyano vinyl group, 2cyano-2- methyl carboxyl vinyl group and 2- cyano-2methyl sulfone vinyl group or other alkenyl group can belisted.

[0013] R4 displays hydrogen atom, cyano group, alkyl group, aralkyl group, the carbocyclic aryl group, heterocyclic aryl group or alkenyl group, displays preferably, hydrogen atom and the alkyl group. As embodiment of R4, hydrogen atom; cyano group; for example methyl group, ethyl group, n-propyl group, iso-propyl group, n-butyl group, iso-butyl group, s-butyl group, t-butyl group, n-pentyl group, iso-pentyl group, 2- methyl butyl group, 1- methyl butyl group, neo-pentyl group, 1, 2- dimethyl propyl group, 1, 1- dimethyl propyl group, cyc lo-pentyl group, n-hexyl group, 4-methyl group, 3- methyl pentyl group, 2- methyl pentyl group, 1- methyl pentyl group, 3, 3- dimethylbutyl

ブチル基、1.2-ジメチルブチル基、1.1-ジメチルブチル基、 3-エチルプチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、 1,2,2-トリメチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1 -エチル-2- メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプ チル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチ ルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチル 基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2.5-ジメチルヘキ シル基、2,5,5-トリメチルペンチル基、2,4-ジメチルヘキシ ル基、2,2,4-トリメチルペンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、 4-エチル-4,5- ジメチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ド デシル基、1,3,5,7-テトラメチルオクチル基、4-ブチルオク チル基、6,6-ジエチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチ ル-4- ブチルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシ ル基、3,5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、 2,4-ジメチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基 、1-cyclo-ペンチル-2,2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシル-2,2- ジメチルプロピル基等の直鎖、分岐または環 状のアルキル基:

【0014】例えば、ベンジル基、ニトロベンジル基、シア ノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベンジル基、 ジメチルペンジル基、トリメチルペンジル基、ジクロロペン ジル基、メトキシペンジル基、エトキシペンジル基、トリフ ルオロメチルペンジル基、ナフチルメチル基、ニトロナフチ ルメチル基、シアノナフチルメチル基、ヒドロキシナフチル メチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナ フチルメチル基等のアラルキル基:例えば、フェニル基、ニト ロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、 メチルフェニル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニ ル基、ジクロロフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシ フェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、N,Nージメチル 、アミノフェニル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノ ナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフチル基、ト リフルオロメチルナフチル基等の炭素環式アリール基:ピロリ ル基、チェニル基、フラニル基、オキサゾイル基、イソオキ サゾイル基、オキサジアゾイル基、イミダゾイル基、ペンゾ オキサゾイル基、ペンゾチアゾイル基、ペンゾイミダゾイル 基、ペンゾフラニル基、インドイル基等の複素環式アリール 基:例えば、ビニル基、プロペニル基、1-ブテニル基、iso -ブテニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテニル基、2-メチル -1- ブテニル基、3-メチル-1- ブテニル基、2-メチル-2-ブテニル基、2,2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2-メチルカ ルボキシルビニル基、2-シアノ-2- メチルスルホンビニル基 等のアルケニル基を挙げることができる。

【0015】 R_{10} および R_{11} はフッ素原子、アルキル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルコキシ基を表し、好ましくは、フッ素原子を表す。

group, 2, 3- dimethylbutyl group, 1, 3- dimethylbutyl group, 2, 2- dimethylbutyl group, 1, 2- dimethylbutyl group, 1, 1dimethylbutyl group, 3- ethyl butyl group, 2- ethyl butyl group, 1-ethyl butyl group, 1,2, 2-trimethyl butyl group, 1,1, 2- trimethyl butyl group, alkyl group of 1- ethyl-2- methyl propyl group, cyc lo-hexyl group, n-heptyl group, 2methyl hexyl group, 3- methyl hexyl group, 4- methyl hexyl group, 5- methyl hexyl group, 2, 4- dimethyl pentyl group, noctyl group, 2- ethylhexyl group, 2,5- dimethyl hexyl group, 2,5,5- trimethyl pentyl group, 2, 4- dimethyl hexyl group, 2,2, 4- trimethyl pentyl group, n- nonyl group, 3,5,5- trimethyl hexyl group, n-decyl group, 4- ethyl octyl group, 4- ethyl-4. 5- dimethyl hexyl group, n- undecyl group, n- dodecyl group, 1,3,5,7- tetramethyl octyl group, 4- butyl octyl group, 6,6diethyl octyl group, n-tridecyl group, 6-methyl-4- butyl octyl group, n-tetradecyl group, n-pentadecyl group, 3,5dimethyl heptyl group, 2,6-dimethyl heptyl group, 2,4dimethyl heptyl group, 2,2,5,5- tetramethyl hexyl group, 1cyc lo-pentyl-2, 2- dimethyl propyl group, 1-cyc lo-hexyl-2, 2- dimethyl propyl group or other straight chain and branched or cyclic;

[0014] For example benzyl group, nitrobenzyl group, cyano benzyl group, hydroxy benzyl group, methylbenzyl group, dimethyl benzyl group, trimethyl benzyl group, dichloro benzyl group, methoxy benzyl group, ethoxy benzyl group, trifluoromethyl benzyl group, naphthyl methyl group, nitro naphthyl methyl group, cyano naphthyl methyl group, hydroxy naphthyl methyl group, methyl naphthyl methyl group, trifluoromethyl naphthyl methyl group or other aralkyl group; for example phenyl group, nitrophenyl group. cyanophenyl group, hydroxyphenyl group, methyl phenyl group, dimethylphenyl group, trimethyl phenyl group, dichlorophenyl group, methoxyphenyl group, ethoxyphenyl group, trifluoromethyl phenyl group, N, N-dimethylamino phenyl group, naphthyl group, nitro naphthyl group, cyano naphthyl group, hydroxy naphthyl group, methyl naphthyl group, trifluoromethyl naphthyl group or other carbocyclic aryl group; pyrrolyl group, thienyl group, furanyl group and oxa y yl group, isoxazoyl basis, oxa diazo yl group, imidazoyl group and benzo ox y yl group, benzo thiazoyl group, benzo imidazoyl group, benzofuranyl group and India yl group or other heterocyclic aryl group; for example vinyl group, propenyl group, 1-butenyl group, iso-butenyl group, 1- pentenyl group, 2- pentenyl group, the 2- methyl-1butenyl group, 3-methyl-1- butenyl group, 2-methyl-2butenyl group, 2, 2- di cyano vinyl group, 2- cyano-2methyl carboxyl vinyl group and 2- cyano-2- methyl sulfone vinyl group or other alkenyl group can belisted.

[0015] R10 and R11 displays fluorine atom , alkyl group , aral kyl group , carbocyclic aryl group , the heterocyclic aryl group or alkoxy group, displays preferably and fluorine atom. As

R₁₀およびR₁₁の具体例としては、フッ素原子:例えば、メ チル基、エチル基、n~プロピル基、iso-プロピル基、n-ブチ ル基、iso-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチ ル基、iso-ペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル 基、neo-ペンチル基、1, 2-ジメチルプロピル基、1, 1-ジメチ ルプロピル基、cyclo-ペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチル ペンチル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1 -メチルペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチル ブチル基、1,3-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、 1.2-ジメチルブチル基、1.1-ジメチルブチル基、3-エチルブ チル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1.2.2-トリ メチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1-エチル-2-メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキシル 基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチル基、n-オク チル基、2-エチルヘキシル基、2.5-ジメチルヘキシル基、2 ,5,5-トリメチルペンチル基、2,4-ジメチルヘキシル基、2, 2,4-トリメチルペンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチル ヘキシル基、n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4,5- ジメチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基 、1, 3, 5, 7-テトラメチルオクチル基、4-ブチルオクチル基、 6,6-ジェチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブ チルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3 . 5-ジメチルヘプチル基、2.6-ジメチルヘプチル基、2.4-ジ メチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-c yclo-ペンチル-2,2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシ ル-2,2- ジメチルプロピル基等の直鎖、分岐または環状のア ルキル基:

【0016】例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロポキ シ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ基、iso-ブトキシ基、 sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基、n-ペントキシ基、iso-ペン トキシ基、neo-ペントキシ基、n-ヘキシルオキシ基、n-ド デシルオキシ基等のアルコキシ基;例えば、ペンジル基、ニ トロペンジル基、シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基 、メチルペンジル基、ジメチルペンジル基、トリメチルペン ジル基、ジクロロペンジル基、メトキシペンジル基、エトキ シペンジル基、トリフルオロメチルペンジル基、ナフチルメ チル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル基 、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、 トリフルオロメチルナフチルメチル基等のアラルキル基:例え ば、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒ ドロキシフェニル基、メチルフェニル基、ジメチルフェニル 基、トリメチルフェニル基、ジクロロフェニル基、メトキシ フェニル基、エトキシフェニル基、トリフルオロメチルフェ ニル基、N, N-ジメチルアミノフェニル基、ナフチル基、ニト ロナフチル基、シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、 メチルナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基等の炭素 環式アリール基:ピロリル基、チェニル基、フラニル基、オキ サゾイル基、イソオキサゾイル基、オキサジアゾイル基、イ

embodiment of R10 and R11, fluorine atom; for example methyl group, ethyl group, n-propyl group, iso-propyl group, n-butyl group, iso-butyl group, s-butyl group, tbutyl group, n-pentyl group, iso-pentyl group, 2-methyl butyl group, 1- methyl butyl group, neo- pentyl group, 1, 2dimethyl propyl group, 1, 1- dimethyl propyl group, cyc lopentyl group, n-hexyl group, 4- methyl pentyl group, 3methyl pentyl group, 2- methyl pentyl group, 1- methyl pentyl group, 3, 3-dimethylbutyl group, 2, 3-dimethylbutyl group, 1, 3- dimethylbutyl group, 2, 2- dimethylbutyl group, 1, 2- dimethylbutyl group, 1, 1- dimethylbutyl group, 3- ethylbutyl group, 2- ethyl butyl group, 1- ethyl butyl group, 1,2,2trimethyl butyl group, 1,1, 2- trimethyl butyl group, alkyl group of 1-ethyl-2- methyl propyl group, cyc lo-hexyl group, n-heptyl group, 2-methyl hexyl group, 3-methyl hexyl group, 4- methyl hexyl group, 5- methyl hexyl group, 2, 4- dimethyl pentyl group, n- octyl group, 2- ethylhexyl group, 2,5-dimethyl hexyl group, 2,5,5-trimethyl pentyl group, 2, 4- dimethyl hexyl group, 2,2, 4- trimethyl pentyl group, n-nonyl group, 3,5,5- trimethyl hexyl group, ndecyl group, 4- ethyl octyl group, 4- ethyl-4,5- dimethyl hexyl group, n-undecyl group, n-dodecyl group, 1,3,5,7tetramethyl octyl group, 4- butyl octyl group, 6,6- diethyl octyl group, n-tridecyl group, 6-methyl-4- butyl octyl group, n-tetradecyl group, n-pentadecyl group, 3,5dimethyl heptyl group, 2,6-dimethyl heptyl group, 2,4dimethyl heptyl group, 2,2,5,5- tetramethyl hexyl group, 1cyc lo- pentyl-2, 2- dimethyl propyl group, 1- cyc lo- hexyl-2, 2- dimethyl propyl group or other straight chain and branched or cyclic;

[0016] For example methoxy group, ethoxy group, n-propo xy group, iso-propoxy group, n-butoxy group, iso-butoxy group, s-butoxy group, t-butoxy group, n-pentoxy group, iso-pentoxy group, neo-pentoxy group, n-hexyloxy group and n - dodecyl oxy group or other alkoxy group; for example benzyl group, nitrobenzyl group, cyano benzyl group, hydroxy benzyl group, methylbenzyl group, dimethyl benzyl group, trimethyl benzyl group, dichloro benzyl group, methoxy benzyl group, ethoxy benzyl group, trifluoromethyl benzyl group, naphthyl methyl group, nitro naphthyl methyl group, cyano naphthyl methyl group, hydroxy naphthyl methyl group, methyl naphthyl methyl group, trifluoromethyl naphthyl methyl group or other aralkyl group; for example phenyl group, nitrophenyl group, cyanophenyl group, the hydroxyphenyl group, methyl phenyl group, dimethylphenyl group, trimethyl phenyl group, dichlorophenyl group, methoxyphenyl group, the ethoxy phenyl group, trifluoromethyl phenyl group, N. Ndimethylamino phenyl group, naphthyl group, nitro naphthyl group, cyano naphthyl group, the hydroxy naphthyl group, methyl naphthyl group, trifluoromethyl

ミダゾイル基、ベンゾオキサゾイル基、ベンゾチアゾイル基 、ベンゾイミダゾイル基、ベンゾフラニル基、インドイル基 等の複素環式アリール基を挙げることができる。

【0017】本発明の一般式(1)で示されるベンソピロメテン化合物は、其自体公知の方法に従って製造することができる。例えば、Journal of Chemical Society, Chemical Communication, 1994, 1129-1130に記載の方法に従い製造される一般式(2)(化3)で示される化合物と、三フッ化ホウ素類とを反応させて、一般式(3)(化3)で示される化合物を製造した後、フッ素原子を置換して一般式(1)で示されるベンゾピロメテン化合物を合成する。

[0018]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
R_7 & R_5 \\
R_8 & R_4 & R_9 \\
R_9 & H & R_1
\end{array}$$
(2)

(上式中、 $R_1 \sim R_9$ は前記に同じ。)本発明に用いられる一般式(1)で示されるベンソピロメテン化合物の具体例としては、例えば、第1表(表1 \sim 3)に示す化合物を挙げることができるが、本発明はこれらの例示化合物に限定されるものではない。

[0019]

naphthyl group or other carbocyclic aryl group; pyrrolyl group, thienyl group, furanyl group and oxyyl group, isoxazoyl basis, oxa diazo yl group, imidazoyl group and benzo oyyl group, the benzo thiazoyl group, benzo imidazoyl group, benzofuranyl group and India yl group or other heterocyclic aryl group can be listed.

[0017] Following to it itself known method, it can produce ben zo pyro methene compound which is shownwith General Formula (1) of this invention. Reacting with compound and boron trifluoride which are shown with General Formula (2) (Chemical formula 3) which is produced in accordance with method which is stated in the for example Journal of the Chemical Society, Chemical Communications (1359-7345, JCCCAT), 1994, 1129-1130, after producing compound which is shown with general formula (3) (Chemical formula 3), substituting fluorine atom, it synthesizes benzo pyro methene compound which is shown with the General Formula (1).

[0018]

[Chemical Formula 3]

Compound which is shown in for example Table 1 (Table 1 to 3) as embodiment of benzo pyro methene compound which is shown with General Formula (1) which is used for (In above equation, as for R1 to R9 same to description above.) this invention, can be listed, but this invention is not something which is limited in these example compound.

[0019]

【表 1】|

[Table 1]

	E E	æ		æ	4	ع	œ.	æ	æ	P.	ď.
	ರ್, ೧೯೩೬ ರಾ, ೫	ร์		I	r	I	I	I	Ŷ	щ	14.
	ж, н д	ਝੰ		I	I	I	Ŧ	I	Ŷ	. L	L
	су, н Су, н	ર્ક		I	I	, =	I	I	OOF!	ıL	ıL
н м. н н н н н ж б н н н н н н н н б	CM, (CM2)2CM(CM2)2 CM3 H			I	I	×	I	I	\$00 \$	iL.	L
	ť ľ	بر پ		I	I	r	I	I	±°	L	LL.
	_ተ	₹.		I	I	t-Bu	t-Bu	I	Ŷ	L	· LL
	ሄ ሪ	ı,		I	I	I	· =	I	ชื	ıL	4.
	I	Ŷ		I	I	I	I	I	I	u.	L
		ទឹ		I	I	I	I	I	٩	u.	ц
1 1 1 5 1 1 1 5	I	ť		r	Ĭ	I	I	I		u.	Jr.
r r b r r b	± ♦ %	P		I	I	I	I	I	₩ Ç-B	ıL	L
± &		4	_	ਝੰ	I	I	I	I	?	u.	L.
දු දු	т Ж	I		I	I	I	I	I	Ŷ	īr	u.
	H +Bu H H	I		I	క్	ર્ફ	ಕ	క్	P	Ŀ	u.

[0020]

[0020]

化合物	ď	æ	æ	æ	æ	æ	ď	æ	æ	P ₁ 0	A,
1-16	∞ 254	n-C ₆ H ₁₃	∞25H	I	I	Ξ	-SQ-t-Bu	I	ጎ ሪ	L	LL.
1-18	క	8 8	Ŷ	3	Ę	Ą	8	Ą	I .	9	is.
1-17	ಕೆ	۵	±°	I	I	x	σ	I	Ģ	n-C ₆ H ₁₁	n-C ₆ H ₁ ,
- 8	\$ ():	T -	I	ક	I	I	I	I	o) 458	(CH ₂) ₂ CH(CH ₃)	s) ₂ (CH ₂) ₂ CH(CH ₃);
1.19	8	ೲೲೲೲ	ž	I	I	I	I	I	Ŷ	L.	u.
1-20	8	ર્ક	±ೆ ೮	I	82.Hg	8,	902 H	8	б	L	.
1-21	Çz	ર્ક	ર્ક	र्ह	I	I	Ŧ	I	# %	щ	L.
1-22	-8÷Bu	٥	Ö	I	I	t-Bu	t-Bu	I	P	Ç ≥	L
1-23	ξ	₽¢,₩	I	9	I	I	I	I	& #8	- <u>8</u>	8
1-24	ť	O~O+Bu	కో	Ŷ	r	I	I	I	∞ _t α⊢α,	L	ia.
1-26	₹°	. 8	I	ઠ	I	t-Bu	t-Bu	I	8	L	Ŷ
1.26	క	CONH(CH ₃) ₂	_ 		E E	Ŷ	P	I	∞2cH2cocH3 InC6H11	ր Հ ցել,	n-C ₆ H ₁₁
1-27	∞_2 CH	NHCOC2H ₆	కో	Ž I	ર્ફ	ಕೆ	కే	ર્ક	Ŷ	u.	(CH ₂) ₂ CH(CH ₃) ₂
1-28	ť	⊘ ∞H	కో	I	I	I	I	I	(=)	IL.	Ľ.

[0021]

[0021]

H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	6		4	4			1	1			
H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	Di .			2	اع	2	2	2	æ	£.	æ
CH-CH ₂ H H H H CH-Ch ₁ CH-CH ₂ H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H CH-Ch ₂ CH-CH ₂ H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	ф° .		ર્કેં		I	I	I	I	♦	ğ	L
H G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	<u> </u>		ર્કે	II		Ι.	I	I	-SA-t-Bu	P.C.H.	PC ₆ H ₁₁
H H H H H H M M M M M M M M M M M M M M	д, ОСН,	_	ਝੌ	I	ರ	Ö	Ö	٥	t-Bu	₹;0	Z.O
CHECH2 H H H H CHECH2 ON H H H H CHECH2 H OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 Mis H OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 Mis F	OH CONT.	U	ź	r	I	I	x	I	P	Œ <u>,</u>	Æ- <u>‡</u>
TH H H H H CONTAGE FOR THE CONTAGE FOR THE CONTAGE CONTAGE CONTAGE CONTAGE CONTAGE CONTAGE FOR THE CONTAGE FOR THE CONTAGE CON			ŕ	2 4 4 5	I	· I	I	I		P	Ç
н н осм ₃ осм ₃ н н	C.F. CON(CH.OCH.)? a		£	б	I	I	=	r	\$ \$	Ľ	u.
H OCH, OCH, OCH,	¢ ∞,√	0	ŕ	I	I	8	8	I	9	ш	L
	Q, CHCH,		I	I	8	8	8	8	¥ Ç	u.	u.

【0022】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間に、 少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を、少なくとも 一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正 孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レ ベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する 正孔注入輸送層または/および電子注入輸送成分を含有する 電子注入輸送層を設けることもできる。例えば、発光層に使

[0022] Organic electroluminescent element, usually, between pair of electrodes, at least one layer clamping doing theluminescent layer which contains light emission component of at least 1 kind, is something whichbecomes. It considers each functional level of positive hole injection and positive hole transport, the electron injection and electron transport of compound which is used for luminescent layer, it ispossible also

用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能または/および電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層または/および電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子(一層型の素子)の構成とすることもできる。また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。|

【0023】本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、前記一般式(1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子である。本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、発光成分または電子注入輸送成分に用いることがより好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、一般式(1)で表される化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0024】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、(A) 陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B) 陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C) 陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D) 陽極/発光層/陰極型素子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E) 陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/電子注入輸送層/記述であるが、とい電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させ

to provide electron-implanted transport layer which contains positive hole injection transport layer and/or electron injection transportcomponent which contains positive hole injection transport component according to desire. When positive hole injection function and positive hole transport functional and/or electron injection function of compoundwhich is used for for example luminescent layer, electron transport function is satisfactory, it it canconstitute of element of type where luminescent layer combines the positive hole injection transport layer and/or electron-implanted transport layer. Of course, it is possible also to constitute of element (element of single layer type) of thetype which does not provide layer of both of positive hole injection transport layer or theelectron-implanted transport layer depending upon in case. In addition, respective layer of positive hole injection transport layer, electronimplanted transport layer and theluminescent layer, even when being a construction more, may be multilayer construction, the positive hole injection transport layer and electron-implanted transport layer can also constitute providing layer whichpossesses injection function in respective layer, and layer whichpossesses transport function separately.

[0023] Organic electroluminescent element of this invention, b etween pair of electrodes, at least one layer clamping doing layerwhich at least 1 kind contains, compound which is displayed with theaforementioned General Formula (1), is organic electroluminescent element which becomes. In organic electroluminescent element of this invention, as for compound which is displayed withthe General Formula (1), positive hole injection transport component, it is desirable to use for the light emission component or electron injection transport component or electron injection transport component. Regarding organic electroluminescent element of this invention, it is possible to use compoundwhich is displayed with General Formula (1), with alone, or multiple tojointly use is possible.

[0024] As constitution of organic electroluminescent element of this invention, it is not something whichespecially is limited, for example (A) anode / positive hole injection transport layer / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode type element (Figure 1), (B) anode / positive hole injection transport layer / luminescent layer / cathode type element (Figure 2),the (C) anode / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode type element (Figure 3) and (D) anode / luminescent layer / cathode type element (Figure 4) etc can be listed. Furthermore, it is possible also to make (E) anode / positive hole injection transport layer / electron-implanted transport layer / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode type element (Figure 5) whichis a element of type which inserts luminescent layer with electron-implanted transport layer. As element configuration

P.16

た型の素子(図7)、または(H)発光成分および電子注入 輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた 型の素子(図8)がある。

【0025】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子、(G)型素子または(H)型素子であり、さらに好ましくは、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(F)型素子または(H)型素子である。

【0026】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、7は電源を示す。

【0027】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート(例えば、ポリエチレンなどのシート、ポリカーボネート、ポリスルフォン、ポリメチルメテクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのシート、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックス、あるいは、これらを組み合わせた複合シートからなるもフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色

of (D) type, light emission component more with shape element of type which clamping isdone of course is between pair of electrodes but, Furthermore, for example (F) positive hole injection transport component, element (Figure 6) of type which with shape which mixes light emission component and the electron injection transport component clamping is done more between pair of electrodes, with (G) positive hole injection transport component and with element (Figure 7), or (H) light emission component of type which shape which mixes light emission component clamping is done more between pair of electrodes and there is a element (Figure 8) of type which theshape which mixes electron injection transport component clamping is done morebetween pair of electrodes.

[0025] Organic electroluminescent element of this invention is not something which is limited to theseelement configuration, positive hole injection transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer multiple layers can be provided in the element of respective type. In addition, with positive hole injection transport layer and luminescent layer, positive hole injection transport componentand with of mixed layer and/or luminescent layer and electron-implanted transport layer of light emission component, it is possible also n element of respective type, to provide mixed layer of light emission componentand electron injection transport component. Constitution of a more desirable organic electroluminescent element, (A) type element, (B) typeelement, (C) type element, (E) type element, (F) type element, is the(G) type element or (H) type element, furthermore preferably and (A)type element, (B) type element, (C) type element, is (F) type elementor (H) type element.

[0026] As organic electroluminescent element of this invention, you explain concerning (A) anode / positive hole injection transport layer / luminescent layer / electron-implanted transport layer / cathode typeelement which is shown in for example (Figure 1). In (Figure 1), as for 1 as for substrate and 2 as for theanode and 3 as for positive hole injection transport layer and 4 as for luminescent layer and 5 as for electron-implanted transport layer and 6 as for cathode and the7 power supply is shown.

[0027] It is not something where as for organic electroluminesc ent element of this invention, it is desirable, to be supported in substrate 1, especially limits as the substrate. It is desirable, for example glass sheet and transparent plastic sheet (for example polyester, polycarbonate, polysulfone, polymethyl methacrylate, polypropylene and polyethylene or other sheet), semitransparent plastic sheet, quartz and the transparent ceramic, or, to be a transparent or semitransparent, can list those which consist of the composite sheet which combines these. Furthermore, to substrate, is possible also fact

をコントロールすることもできる。

【0028】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい金属 、合金または電気電導性化合物を電極物質として使用するこ とが好ましい。陽極に使用する電極物質としては、例えば、 金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラジウム、パナ ジウム、タングステン、酸化錫、酸化亜鉛、ITO(インジ ウム・ティン・オキサイド)、ポリチオフェン、ポリピロー ルなどを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で 使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。陽極は、こ れらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の 方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極 は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよ い。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/口以下 、より好ましくは、5~50Ω/口程度に設定する。陽極の 厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~ 1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度 に設定する。

【0029】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、本発明に係る一般式(1)で表される化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、ポリフェニレンピニレンおよびその誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンピニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリーNーピニルカルパゾール誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

 that emission color iscontrolled combining for example color filter film, color conversion film and dielectric reflective film.

[0028] As anode 2, as electrode substance, it is desirable to use metal, the alloy or electrical conductivity compound where work function is large relatively. for example gold, platinum, silver, copper, cobalt, nickel, the palladium, vanadium, tungsten, tin oxide, zinc oxide, ITO (indium * tin * oxide), the polythiophene and polypyrrole etc can be listed as electrode substance which is used forthe anode. It is possible to use these electrode substance, with alone, or plural tojointly use is possible. It can form anode, on substrate these electrode substance, with for example vapor deposition method andthe sputtering method or other method. In addition, anode may be structure more, or to be multilayer structure ispossible. It sets sheet electrical resistance of anode, to preferably, several hundred /square or below, more preferably and the 5 to 50 /square extent. thickness of anode, it depends on also material of electrode substancewhich is used, but generally, it sets to 5 to 1000 nm extent, more preferably and the 10 to 500 nm extent.

[0029] Positive hole injection transport layer 3 makes fill of po sitive hole (hole) from anode easy is layerwhich contains compound which possesses function which transportsthe positive hole which functioned, and was filled and, at least 1 kind using compound (Such as for example phthalocvanine derivative, triaryl methane derivative, triaryl amine derivative, oxazole derivative, hydrazone derivative, stilbene derivative, pyrazoline derivative, poly silane derivative, polyphenylene vinyleneand its derivative, polythiophene and its derivative and poly N - vinyl carbazole derivative) which possesses compound and/or other positive hole injection transport function which is displayed with General Formula (1) which relates to this invention it canform positive hole injection transport layer. Furthermore it is possible to use compound which possesses the positive hole injection transport function, with alone, or plural to jointly use is possible.

[0030] Regarding to this invention, triaryl amine derivative (f or example 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (4" - methylphenyl) amino) biphenyl , 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl , 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methoxyphenyl) amino) biphenyl , 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (1" - naphthyl) amino) biphenyl , 3, 3'-di methyl - 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl , 1,1 - bis (4' - [N,N-di (4" - methylphenyl) amino) biphenyl) cyclohexane , 9,10 - bis (N - (4' - methylphenyl) - N - (4" - n-butyl phenyl) amino) phenanthrene , 3,8 - bis (N,N-di phenylamino) - 6 - phenyl phenanthridine and 4 - methyl - N,N - bis (4",4" - bis [N',

)-N-(4 " -n-ブチルフェニル)アミノ] フェナント レン、3、8-ピス(N、N-ジフェニルアミノ)-6-フ ェニルフェナントリジン、4-メチル-N、N-ビス〔4" . 4''' ーピス[N' . N' ージ (4ーメチルフェニル) ア ミノ】ピフェニルー4ーイル】アニリン、N, N' ーピス〔 4-(ジフェニルアミノ)フェニル]-N, N'-ジフェニ ルー1,3ージアミノベンゼン、N, N' ーピス〔4ー(ジ フェニルアミノ) フェニル] -N. N' -ジフェニル-1, 4-ジアミノペンゼン、5、5"-ビス[4-(ビス[4-メチルフェニル] アミノ) フェニル] -2, 2': '5', 2 "ーターチオフェン、1, 3, 5ートリス(ジフェニルアミ ノ)ベンゼン、4、4'、4"ートリス(Nーカルパゾリル) トリフェニルアミン、4, 4', 4"-トリス [N-(3 ··· ーメチルフェニル)-N-フェニルアミノ}トリフェニ ルアミン、1. 3. 5ートリス〔Nー(4'ージフェニルア ミノフェニル) フェニルアミノ] ベンゼンなど) 、ポリチオ フェンおよびその誘導体、ポリーN-ビニルカルパゾール誘 導体がより好ましい。本発明において、一般式 (1) で表さ れる化合物と他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併用す る場合、正孔注入輸送層中に占める一般式 (1) で表される 化合物の割合は、好ましくは、0. 1~40重量%程度に調 製する。|

【0031】発光層4は、正孔および電子の注入機能、それ らの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させ る機能を有する化合物を含有する層である。発光層は、一般 式(1)で表される化合物および/または他の発光機能を有 する蛍光性化合物(例えば、アクリドン誘導体、キナクリド ン誘導体、多環芳香族化合物〔例えば、ルブレン、アントラ セン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシク レン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジェン、ペン タフェニルシクロペンタジエン、9, 10ージフェニルアン トラセン、9、10-ビス(フェニルエチニル)アントラセ ン、1、4-ビス(9'-エチニルアントラセニル)ペンゼ ン、4、4'ーピス(9"ーエチニルアントラセニル)ピフ ェニル〕、トリアリールアミン誘導体〔例えば、正孔注入輸 送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げることが できる〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノリノラ ート)アルミニウム、ピス(10-ベンゾ[h]. キノリノラー ト) ベリリウム、2ー(2'ーヒドロキシフェニル)ベンゾ オキサゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル) ペンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜 鉛塩】、スチルベン誘導体〔例えば、1,1,4,4-テト ラフェニルー1、3ープタジエン、4、4'ーピス(2, 2 ージフェニルビニル)ピフェニル〕、クマリン誘導体〔例え ば、クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、 クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリ ン152、クマリン153、クマリン307、クマリン31 1、クマリン314、クマリン334、クマリン338、ク マリン343、クマリン500〕、ピラン誘導体〔例えば、 DCM1、DCM2]、オキサゾン誘導体[例えば、ナイル レッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘 導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導体、ケイ皮

N'-di (4 - methylphenyl) amino] biphenyl - 4-yl) aniline, N. N - bis (4 - (diphenylamino) phenyl) - N, N - di phenyl - 1.3di amino benzene, N, N' - bis (4 - (diphenylamino) phenyl) -N, N'-di phenyl - 1,4-di amino benzene , 5,5" - bis (4 - (bis [4 methylphenyl] amino) phenyl) - 2, 2': 5', 2" - terthiophene. 1,3,5 - tris (diphenylamino) benzene, 4, 4', 4" - tris (N carbozolyl) triphenyl amine and 4, 4', 4" - tris (N - (3" methylphenyl) - N - phenylamino) triphenyl amine , such as 1, 3,5 - tris (N - (4'-di phenylamino phenyl) phenylamino) benzene), polythiophene and its derivative and the poly Nvinyl carbazole derivative are more desirable as compound which possesses other positive hole injection transport function which it uses. Regarding to this invention, when it jointly uses compound which possessesthe compound and other positive hole injection transport function which are displayed with General Formula (1), as for ratio of compound which is displayed with General Formula (1) which itoccupies in positive hole injection transport layer, it manufactures in preferably and 0.1 to 40 weight % extent.

[0031] Luminescent layer 4 is layer which contains compound which possesses the function which forms exciton injection function of positive hole and electron, those transport function, with recombination of positive hole and electron. at least 1 kind using fluorescence compound (for example acridone derivative, quinacridone derivative, polycyclic aromatic compound (for example rubrene, anthracene, tetracene, pyrene, perylene, chrysene, decacyclene, coronene, tetra phenyl cyclopentadiene, pentaphenyl cyclopentadiene, 9,10-di phenyl anthracene, 9,10 - bis (phenyl ethinyl) anthracene, 1,4 - bis (9' - ethinyl anthracenyl) benzene, 4, 4' - bis (9" - ethinyl anthracenyl) biphenyl), triaryl amine derivative (compound which you mention earlier as compound which possesses for example positive hole injection transport function can be listed), organometallic complex (for example tris (8 - quinolinolato) aluminum, bis (10 - benzo [h] quinolinolato) beryllium, zinc salt of 2 - (2' hydroxyphenyl) benzoxazole, zinc salt of 2 - (2' hydroxyphenyl) benzothiazole, zinc salt of 4 - hydroxy acridine), stilbene derivative (for example 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 - butadiene, 4, 4' - bis (2,2-di phenyl vinyl) biphenyl), coumarin derivative (for example coumarin 1, coumarin 6, coumarin 7, coumarin 30, coumarin 106, coumarin 138, coumarin 151, coumarin 152, coumarin 153, coumarin 307, coumarin 31 1, coumarin 31 4, coumarin 334. coumarin 338, coumarin 343 and coumarin 500), such as pyran derivative (for example DCM1 and DCM2), oxazone derivative (for example Nile red), benzothiazole derivative, benzoxazole derivative, benzimidazole derivative, pyrazine derivative, cinnamic acid ester derivative, poly N - vinyl

酸エステル誘導体、ポリーNービニルカルパソールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレン ビニレンおよびその誘導体、ポリダーフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。

[0032] 本発明の有機電界発光素子においては、発光層に一般式(1)で表される化合物を含有していることが好ましい。一般式(1)で表される化合物と他の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.001~99.9991126%程度、より好ましくは、0.01~99.991126%程度、さらに好ましくは、0.1~99.912126%程度に調製する。

【0033】本発明において用いる他の発光機能を有する化合物としては、発光性有機金属錯体がより好ましい。例えば、J. Appl. Phys., 65、3610(1989)、特開平5-214332号公報に配載のように、発光層をホスト化合物とサポスト化合物(ドーパント)とより構成することもできる。一般式(1)で表される化合物を、ホスト化合物として用いて発光層を形成することができ、さらには、ゲスト化合物として用いて発光層を形成することもできる。一般式(1)で発光層を形成することもできる。一般式(1)で表される化合物を、ゲスト化合物として用いて発光層を形成するして開いて発光層を形成することもできる。一般式(1)で表される化合物を、好ましくは、発光性有機金属錯体に対して、一般式(1)で表される化合物を、好ましくは、0.001~40重量%程度、より好ましくは、0.01~30重量%程度、特に好ましくは、0.1~10重量%程度使用する。

【〇〇34】一般式(1)で表される化合物と併用する発光性有機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の8ーキノリノラート配位子を有する発光性有機アルミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることができる。

$$(Q)_3 - AI$$
 (a)

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子

carbazole and its derivative, polythiophene and its derivative, polyphenylene and its derivative, poly fluorene and its derivative, poly biphenylene vinylene and its derivative, poly biphenylene vinylene and its derivative, poly terphenylene vinylene and its derivative, poly naphthylene vinylene and its derivative) which possesses compound and/or other light emission functionwhich is displayed with General Formula (1) it can form luminescent layer.

[0032] Regarding organic electroluminescent element of this in vention, it is desirable to contain compoundwhich in luminescent layer is displayed with General Formula (1). When compound which possesses compound and other light emission function which are displayed with General Formula (1) is jointly used, as for ratio of compound which is displayed with General Formula (1) which is occupied in luminescent layer, the preferably , 0.001 to 99.999 wt% extent , more preferably and 0.01 to 99.99 wt% extent , furthermore it manufactures in preferably and 0.1 to 99.9 wt% extent.

[0033] Regarding to this invention, luminescent organometalli c complex is more desirable as compound which possesses other light emission function which it uses. As stated in for example Journal of Applied Physics (0021-8979, JAPIAU), 65, 3610 (1989) and Japan Unexamined Patent Publication Hei 5 -214332 disclosure, also to constitute with from thehost compound and guest compound (dopant) it is possible luminescent layer. It is possible, furthermore, to form luminescent layer compound which is displayed with General Formula (1), as host compound using, it is possible also to form luminescent layer as guest compound using. When luminescent layer compound which is displayed with General Formula (1), is formedas guest compound using, luminescent organometallic complex is desirable as host compound. In this case, compound which is displayed with General Formula (1) vis-a-visthe luminescent organometallic complex, is used, preferably, 0.001 to 40 wt% extent, more preferably, 0.01 to 30 wt% extent, the particularly preferably and 0.1 to 10 wt% extent.

[0034] It is not something which especially is limited as lumines cent organometallic complex which isjointly used with compound which is displayed with General Formula (1). luminescent organoaluminum complex is desirable, luminescent organoaluminum complex which possesses substituted or unsubstituted 8 - quinolinolato ligand is moredesirable. As desirable luminescent organometallic complex, luminescent organoaluminum complex which is displayed with for example General Formula (a) to General Formula (c)can be listed.

$$(Q) 3 - Al$$
 (a)

(In Formula, Q displays substituted or unsubstituted 8 - quinolin

を表す) |

$$(Q)_2 - AI - O - L$$
 (b)

(式中、Qは置換8ーキノリノラート配位子を表し、OーLはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を含む炭素数6~24の炭化水素基を表す)

$$(Q)_2 - AI - O - AI - (Q)_2$$
 (c)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す)

【0035】発光性有機金属錯体の具体例としては、例えば 、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウム、トリス(4 ーメチルー8ーキノリノラート)アルミニウム、トリス(5 ーメチルー8ーキノリノラート)アルミニウム、トリス(3 . 4ージメチルー8ーキノリノラート) アルミニウム、トリ ス(4,5ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウム 、トリス(4、6ージメチルー8ーキノリノラート)アルミ ニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(フェノ ラート) アルミニウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラ ート) (2-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2 ーメチルー8ーキノリノラート) (3ーメチルフェノラート) アルミニウム、ピス (2ーメチルー8ーキノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチ ルー8-キノリノラート) (2-フェニルフェノラート) ア ルミニウム、ビス(2ーメチル-8-キノリノラート)(3 ーフェニルフェノラート) アルミニウム、

【0036】ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(4 ーフェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2ーメチル -8-キノリノラート) (2, 3-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2, 6ージメチルフェノラート) アルミニウム、ピス (2-メチルー8ーキノリノラート) (3,4ージメチルフェノラ ート) アルミニウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラー ト) (3, 5-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (3, 5-ジ-tert-ブチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-8 ーキノリノラート) (2,6ージフェニルフェノラート) ア ルミニウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラート)(2 , 4、6ートリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) (2,4,6-トリメ チルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (2, 4, 5, 6ーテトラメチルフェノラ ート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラー ト) (1ーナフトラート) アルミニウム、ビス (2ーメチル -8-キノリノラート) (2-ナフトラート) アルミニウム 、ビス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート)(2ーフ ェニルフェノラート) アルミニウム、ピス(2,4-ジメチ ルー8-キノリノラート) (3-フェニルフェノラート) ア ルミニウム、ビス(2、4ージメチルー8ーキノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2. 4-ジメチル-8-キノリノラート) (3,5-ジメチルフ

olato ligand.)

$$(Q)_2 - Al - O - L$$
 (b)

(In Formula, Q displays substitution 8 - quinolinolato ligand, O - L is the phenolate ligand, L displays carbon number 6 to 24 hydrocarbon group which includes phenyl portion.)

$$(Q) 2 - Al - O - Al - (Q) 2$$
 (c)

(In Formula, Q displays substitution 8 - quinolinolato ligand.)

[0035] As embodiment of luminescent organometallic complex, for example tris (8 - quinolinolato) aluminum and tris (4 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (5 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (3,4-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (4,5-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, tris (4,6-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, the bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2 - methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (4 - methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum,

[0036] Bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (4 - phenyl phen olate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2,3di methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) (2,6-di methyl phenolate) aluminum, bis (2methyl - 8 - quinolinolato) (3,4-di methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (3.5-di methyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) (3,5-di - t-butyl phenolate) aluminum, bis (2 methyl - 8 - quinolinolato) (2,6-di phenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2,4,6 triphenyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) (2,4,6 - trimethyl phenolate) aluminum, bis (2 methyl - 8 - quinolinolato) (2,4,5,6 - tetramethyl phenolate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (1 naphtholate) aluminum, bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) (2 - naphtholate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 quinolinolato) (2 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) (3 - phenyl phenolate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) (4 phenyl phenolate) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 quinolinolato) (3,5-di methyl phenolate) aluminum, bis (2,4di methyl - 8 - quinolinolato) (3,5-di - t-butyl phenolate) aluminum,

ェノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジーtert-ブチルフェノラート) アルミニウム、

【0037】ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アル ミニウムーμーオキソービス(2ーメチルー8ーキノリノラ ート) アルミニウム、ビス(2, 4ージメチルー8ーキノリ ノラート) アルミニウムーμーオキソーピス(2. 4ージメ チルー8ーキノリノラート)アルミニウム、ピス(2ーメチ ルー4-エチル-8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、ビス(2ーメチルー4ーメトキシー8ー キノリノラート)アルミニウムーμーオキソービス(2ーメ チルー4ーメトキシー8ーキノリノラート) アルミニウム、 ピス (2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート) アル ミニウム-μ-オキソーピス(2-メチルー5-シアノー8 ーキノリノラート) アルミニウム、ビス(2ーメチルー5ー トリフルオロメチルー8ーキノリノラート) アルミニウムー μーオキソービス(2-メチルー5-トリフルオロメチルー 8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙げることができ る。勿論、発光性有機金属錯体は、単独で使用してもよく、 あるいは複数併用してもよい。

【0038】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を 容易にする機能、そして注入された電子を輸送する機能を有 する化合物を含有する層である。電子注入輸送層は、一般式 (1) で表される化合物および/または他の電子注入輸送機 能を有する化合物(例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(10-ペンゾ [h] キノリノラート) ベリリウム]、オキサジアゾール誘導/ 体、トリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、ペリレン誘導 体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノ ン誘導体、ニトロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオ キサイド誘導体など)を少なくとも1種用いて形成すること ができる。本発明の有機電界発光素子においては、電子注入 輸送層に、一般式(1)で表される化合物を含有しているこ とが好ましい。一般式 (1) で表される化合物と他の電子注 入輸送機能を有する化合物を併用する場合、電子注入輸送層 中に占める本発明に係る一般式(1)で表される化合物の割 合は、好ましくは、0. 1重量%以上、より好ましくは、0 1~40重量%程度、さらに好ましくは、0.2~30重 量%程度、特に好ましくは、0.5~20重量%程度に調製 する。本発明においては、一般式(1)で表される化合物と 有機金属錯体〔例えば、前記一般式(a)~一般式(c)で 表される化合物〕を併用して、電子注入輸送層を形成するこ とは好ましい。

[0037] Bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - oxo - bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2,4-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo bis (2.4-di methyl - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2 methyl - 4 - ethyl - 8 - quinolinolato) aluminum - oxo - bis (2 - methyl - 4 - ethyl - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2 - methyl - 4 - methoxy - 8 quinolinolato) aluminum - - oxo - bis (2 - methyl - 4 methoxy - 8 - quinolinolato) aluminum, bis (2 - methyl -5 - cyano - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo - bis (2 - methyl - 5 - cyano - 8 - quinolinolato) aluminum and bis (2 - methyl - 5 - trifluoromethyl - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo -bis (2 - methyl - 5 trifluoromethyl - 8 - quinolinolato) aluminum etc can be listed. Of course, it is possible to use luminescent organometallic complex, with alone, or theplural to jointly use is possible.

[0038] Electron-implanted transport layer 5 makes fill of electr on from cathode easy is layerwhich contains compound which possesses function which transportsthe electron which functioned, and was filled and. at least 1 kind using compound (Such as for example organometallic complex (for example tris (8 - quinolinolato) aluminum and bis (10 - benzo [h] quinolinolato) beryllium), oxadiazole derivative, triazole derivative, triazine derivative, perylene derivative, quinoline derivative, quinoxaline derivative, biphenyl quinone derivative, nitro-substituted fluorenone derivative and thiopyran dioxide derivative) which possesses compound and/or other electron-implanted transport function which is displayed with General Formula (1) it can form electron-implanted transport layer. Regarding organic electroluminescent element of this invention, in electron-implanted transport layer, it is desirable tocontain compound which is displayed with General Formula (1). When compound which possesses compound and other electron-implanted transport function which are displayed with General Formula (1) is jointly used, as for ratio of compoundwhich is displayed with General Formula (1) which relates to this invention which isoccupied in electron-implanted transport layer, preferably, 0.1 weight% or greater, more preferably and 0.1 to 40 wt% extent, furthermore it manufactures in preferably, 0.2 to 30 wt% extent, particularly preferably and the 0.5 to 20 wt% extent. Regarding to this invention, jointly using compound and organometallic complex (compound which with for example aforementioned General Formula (a) to General Formula (c) is displayed) which are displayed with General Formula (1), it is desirable to form electron-implanted transport layer.

【0039】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使用することが好ましい。陰極に使用する電極物質としては、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナトリウム、マグネシウムーカリウム合金、カルシウムーインジウム合金、インジウムーのム、アルミニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムーカルシウム合金、アルミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0040】陰極は、これらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Ω/口以下に設定するのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~50nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【〇〇41】また、本発明の有機電界発光素子においては、 その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーが含有さ れていてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限 定するものではなく、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジ フェニルイソペンゾフランなどが挙げられ、特に好ましくは 、ルブレンである。一重項酸素クエンチャーが含有されてい る層としては、特に限定するものではないが、好ましくは、 発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔 注入輸送層である。尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸 素クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一 に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば 、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有 させてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量としては、 含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成する全体量 の0.01~50重量%、好ましくは、0.05~30重量 %、より好ましくは、0.1~20重量%である。|

[0039] As cathode 6, as electrode substance, it is desirable to use metal, the alloy or electrical conductivity compound where work function is small relatively. for example lithium and lithium-indium alloy, sodium and sodium-potassium alloy, the calcium, magnesium and magnesium-silver alloy, magnesium-indium alloy, the indium, ruthenium, titanium, manganese, yttrium, aluminum and the aluminum-lithium alloy, aluminum-calcium alloy, aluminum-magnesium alloy and graphite thin filmetc can be listed as electrode substance which is used for cathode. It is possible to use these electrode substance, with alone, or plural tojointly use is possible.

[0040] It can form cathode, on electron-implanted transport la yer these electrode substance, with for example vapor deposition method, the sputtering method, ionization vapor deposition method, ion plating method and cluster ion beam method or other method. In addition, cathode may be structure more, or to be multilayer structure ispossible. Furthermore as for sheet electrical resistance of cathode, it is desirableto set to several hundred /square or below. thickness of cathode, it depends on also material of electrode substancewhich is used, but generally, it sets to 5 to 1000 nm extent, more preferably and the 10 to 500 nm extent. Furthermore in order to remove light emission of organic electroluminescent elementefficiently, electrode of at least one of anode or cathode, being a transparent or semitransparent isdesirable, in order generally, for transmittance of emitted light to becomethe 70 % or higher, material of anode, it is more desirable to set the thickness.

[0041] In addition, in at least one layer, singlet oxygen quench er may be contained regarding theorganic electroluminescent element of this invention. As singlet oxygen quencher, it is not something which especially is limited, you canlist for example rubrene, nickel complex and biphenyl isobenzofuran etc, it is a particularly preferably and a rubrene. It is not something which especially is limited as layer where the singlet oxygen quencher is contained. It is a preferably, a luminescent layer or a positive hole injection transport layer, is a more preferably and a positive hole injection transport layer. Furthermore when singlet oxygen quencher is contained in for example positive hole injection transport layer, it is possible to uniform to contain in positive hole injection transport layer. to vicinity of the positive hole injection transport layer and adjacent layers (It possesses for example luminescent layer and light emission function electron-implanted transport layer) to contain is possible. As content of singlet oxygen quencher, 0.0 1 to 5 0 wt% of entire amount whichforms layer (for example positive hole injection transport layer) which is contained, it is a preferably, a 0.05 to 30 wt%, a more preferably and a 0.1 to 20 wt%.

【0042】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形 成方法に関しては、特に限定するものではなく、例えば、真 空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例えば、スピンコ ート法、キャスト法、ディップコート法、パーコート法、ロ ールコート法、ラングミュア・プロゼット法など)により薄 膜を形成することにより作製することができる。真空蒸着法 により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定 するものではないが、10-5 Torr 程度以下の真空下で、5 0~400℃程度のボート温度(蒸着源温度)、−50~3 00℃程度の基板温度で、0.005~50nm/sec 程度 の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入 輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連 続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電界発 光素子を製造することができる。真空蒸着法により、正孔注 入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合 物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に 温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0044】溶液塗布法により、各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1ーメチルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメタン、クロロボンゼン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロレルエン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、

[0042] In regard to formation method of positive hole injectio n transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer, it is not something which especially is limited, it can produce by formingthe thin film with for example vacuum vapor deposition method, ionization vapor deposition method and solution coating method (for example spin coating method, casting method, dip coating method, barcoat method and roll coating method, such as Langmuiiプロゼ " jp7method). With vacuum vapor deposition method. when each layer is formed, condition of vacuum vapor deposition is not something which especially is limited. Under vacuum of 10-5 Torr extent or less, boat temperature (vapor deposition source temperature) of 50 to 400 °C extent, with substrate temperature of - 50 to 300 °C extent, it is desirable to execute with vapor deposition rate of 0.005 to 50 nm/sec extent. In this case, positive hole injection transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer or other each layer, under the vacuum, continuing, can produce organic electroluminescent element which is superior more in the characteristics by forming. When it forms with vacuum vapor deposition method, positive hole injection transport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer or other eachlayer, making use of compound of multiple, temperature control doing eachboat which inserted compound individually, codeposition it is desirable to do.

[0043] With solution coating method, when each layer is form ed, component which forms eachlayer or component and binder resin etc. melting in solvent, ordispersing it makes coating solution. positive hole injection transport layer, luminescent layer. You can list for example poly N - vinyl carbazole, polyarylate, polystyrene, polysiloxane, the poly methyl acrylate, poly methyl methacrylate, polyether, polycarbonate, polyamide, polyimide, the polyamideimide, poly paraxylene, polyethylene, polyphenylene oxide, polyether sulfone, polyaniline and theits derivative, polythiophene and its derivative, polyphenylene vinylene and its derivative, poly fluorene and the its derivative, polythienylene vinylene and its derivative or other polymeric compound as binder resin which it can use foreach layer of electron-implanted transport layer. It is possible to use binder resin, with alone, or multiple tojointly use is possible.

[0044] With solution coating method, when each layer is form ed, component which forms each layer or component and binder resin etc, melting in suitable organic solvent (for example hexane, octane, decane, toluene, xylene, ethyl benzene, 1 - methyl naphthalene or other hydrocarbon solvent, for example acetone, methylethylketone, methyl isobutyl ketone, cyclohexanone or other ketone solvent, for example dichloromethane, chloroform, tetrachloro methane, dichloroethane, trichloroethane, tetrachloroethane, chlorobenzene, dichlorobenzene, chlorotoluene or other

酢酸ブチル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、1ーメチルー2ーピロリドン、1,3ージメチルー2ーイミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイド等の極性溶媒)および/または水に溶解、または分散させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成することができる。

【0045】尚、分散する方法としては、特に限定するものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、0.1~50重量%程度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度である。尚、パインダー樹脂を使用する場合、その使用量に関しては、特に限定するものではないが、一般には、各層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量%程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好ましくは、15~90重量%程度に設定する。

【0046】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の膜 厚に関しては、特に限定するものではないが、一般に、5 n m~5μm程度に設定することが好ましい。尚、作製した素 子に対し、酸素や水分等との接触を防止する目的で、保護層 (封止層)を設けたり、また素子を、例えば、パラフィン、 流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼ オライト含有フルオロカーボン油などの不活性物質中に封入 して保護することができる。保護層に使用する材料としては 、例えば、有機高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキ シ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリス チレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチ レン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例えば、ダ イヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、 金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、金属硫化物)、さ らには光硬化性樹脂などを挙げることができ、保護層に使用 する材料は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用して もよい。保護層は、一層構造であってもよく、また多層構造 であってもよい。

halogenated hydrocarbon solvent, for example ethyl acetate, butyl acetate, amyl acetate or other ester type solvent, for example methanol, propanol, butanol, pentanol, hexanol, cyclohexanol, methyl cellosolve, ethyl cellosolve, ethyleneglycol or other alcoholic solvent, for example dibutyl ether, tetrahydrofuran, dioxane, anisol or other ether solvent, for example N,N-dimethylformamide, N,N-dimethylacetamide and 1 - methyl - 2 - pyrrolidone, 1,3-di methyl - 2 - imidazolidinone, dimethyl sulfoxide or other polar solvent) and/orwater, or dispersing it makes coating solution, it can form thin film withthe various painting method.

[0045] Furthermore it is not something which especially is limit ed as themethod which is dispersed. It can disperse to fine particulate state making use of for example ball mill, sand mill, the paint shaker, attritor and homogenizer etc. In regard to concentration of coating solution, it is not something whichespecially is limited, desired thickness is produced it is possible with thepainting method which is executed, to set to concentration range which is suitedgenerally, it is a solution concentration of 0.1 to 50 weight% extent, preferably and 1 to 30 weight% extent. Furthermore when binder resin is used, it is not somethingwhich especially is limited in regard to amount used. Generally, vis-a-vis component which forms each layer (When element of single layer type is formed, in total weight of each component confronting), it sets to the 5 to 99.9 weight% extent, preferably, 10 to 99 weight% extent, more preferably and 15 to 90 weight% extent.

[0046] In regard to film thickness of positive hole injection tra nsport layer, luminescent layer and electron-implanted transport layer, it is not something which especially is limited. Generally, it is desirable to set to 5 nm to 5 m extent. Furthermore with objective which prevents contact with the oxygen and moisture etc vis-a-vis element which is produced, the protective layer (stop layer) is provided, in addition element, is enclosed in for example paraffin, the liquid paraffin, silicon oil, fluorocarbon oil and zeolite content fluorocarbon oil or other inactive substance and it can protect. for example organic polymeric material (for example fluorinated resin, epoxy resin, silicone resin, epoxy silicone resin, polystyrene, polyester, polycarbonate, polyamide, polyimide, polyamideimide, poly paraxylene, polyethylene and polyphenylene oxide), inorganic material (for example diamond thin film, amorphous silica, electrically insulating glass, metal oxide, metal nitride, metal carbonized substance and metal sulfide), furthermore it can list photocurable resin etc asthe material which is used for protective layer, with alone to use material which is used for protective layer, it is possible, or plural to jointlyuse is possible. protective layer may be structure more, in addition to be multilayer structure is possible.

【0047】また、電極に保護膜として、例えば、金属酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【〇〇48】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。尚、印加電圧は、一般に、2~3〇V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0049]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものではない。

実施例1

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、4,4'ーピス〔NーフェニルーNー(1"ーナフチ ル) アミノ] ビフェニルを、蒸着速度 O. 2 n m/sec で 7 5 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、そ の上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと第1 表に示す化合物(1-1)(以下、同じ)を、異なる蒸着源 から、蒸着速度 O. 2 nm/sec で50 nmの厚さに共蒸着 (重量比100:0.5) し、発光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、蒸着速度0.2 n m/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした 。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm /sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1) して 陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ 、58mA/cm² の電流が流れた。輝度2240cd/m 2 の赤橙色の発光が確認された。

[0047] In addition, is possible also fact that for example oxidiz ed metal film (for example aluminum oxide film) and metal fluoride filmare provided as protective film, to electrode. In addition, to surface of for example anode, is possible also fact thatthe interfacial layer (intermediate layer) which consists of for example organophosphorus compound, poly silane, aromatic amine derivative and the phthalocyanine derivative is provided. Furthermore, electrode and for example anode can also use treating surface, with for example acid, ammonia/hydrogen peroxide or plasma.

[0048] It is used as for organic electroluminescent element of th is invention, generally, as element of direct current drive type, but as element of pulse drive type or alternating current drive type you can use. Furthermore applied voltage, generally, is 2 to 30V extent. for example panel type light source, various luminescent element, variousdisplay element, you can use organic electroluminescent element of this invention, for various label and various sensor etc.

[0049]

[Working Example(s)] This invention furthermore is explained in detail below, with Working Example, but it is not something where of course, this invention is limited in these.

Working Example 1

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N - phenyl- N - (1" - naphthyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:0.5) it did compound (1 - 1) (Below, same) which is shown in tris (8 - quinolinolato) aluminum and Table 1, in thethickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and the silver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of

【0050】 実施例2~14

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用する代わりに、化合物(1-2~1-14)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、1:2 Vの直流電圧を印加したところ、赤橙色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表(表4)に示した。

【0051】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物 (1-1) を使用せずに、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムだけを用いて、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表に示した。

【0052】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用する代わりに、1,3,5,7,8ーペンタメチルー4,4ージフルオロー4ーボラー3a,4aージアザーsーインダセンを使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表に示した。

[0053]

12V, current of 58 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 2240 cd/m2 was verified.

[0050] Working Example 2 to 14

In Working Example 1, at time of formation of luminescent la yer, other thanusing compound (1 - 2 to 1 - 14) for substituting which uses compound (1 - 1), organic electroluminescent elementwas produced with method which is stated in Working Example 1. In respective element, under dry atmosphere, when imparting it does the direct current voltage of 12V, light emitting of reddish amber was verified. Furthermore characteristic was inspected, result was shown in the Table 2 (Table 4).

[0051] Comparative Example 1

In Working Example 1, at time of formation of luminescent la yer, without using the compound (1 - 1), vapor deposition it did in thickness of 50 nm making use of just tris (8 - quinolinolato) aluminum, other than making luminescent layer, it produced organic electroluminescent element with method which is stated in Working Example 1. In this element, under dry atmosphere, when imparting it does direct current voltage of the 12V, light emitting of green color was verified. Furthermore characteristic was inspected, result was shown in the Table 2.

[0052] Comparative Example 2

In Working Example 1, at time of formation of luminescent la yer, other thanusing 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4,4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza - s - indacene for thesubstituting which uses compound (1 - 1), organic electroluminescent element was produced with themethod which is stated in Working Example 1. In this element, under dry atmosphere, when imparting it does direct current voltage ofthe 12V, light emitting of green color was verified. Furthermore characteristic was inspected, result was shown in the Table 2.

[0053]

第2表

有機電界	輝度	電流密度
発光素子	(c d/m³.)	(mA/cm²)
実施例 2	2 2 6 0	6 0
実施例 3	2240	5 4
実施例 4	2230	6 1
実施例 5	2260	5 6
実施例 6	2320	5 7
実施例 7	2250	5 5
実施例 8	2300	5 6
実施例 9	2230	5 9
実施例10	2290	5 5
実施例11	2350	5 5
実施例12	2300	5 6
実施例13	2260	6 0
実施例14	2320	6 1
比較例1	1170	8 2
比較例2	1550	6 0

【0054】 実施例15

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10-6 Torr に滅圧した。まず、ITO透明電極 上に、4, 4' ーピス [NーフェニルーNー(3" ーメチル フェニル)アミノ〕ピフェニルを、蒸着速度 0. 2 n m/se c で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム と化合物(1-23)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0. 2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1 . 0)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト) アルミニウムを、蒸着速度 O. 2 nm/sec で50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、 マグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 n m/sec で 200 n m の厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保っ たまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、12Vの直流電圧を印加したところ、58mA/cm² の電流が流れた。輝度1950cd/m²の赤橙色の発光が 確認された。

[0054] Working Example 15

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N - phenyl- N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:1.0)it did tris (8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 23), in thickness of 50 nm, made the luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor

【0055】 実施例16

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 に、4, 4' ーピス [NーフェニルーNー (3" ーメチルフ ェニル)アミノ〕ピフェニルを、蒸着速度 0.2 n m/sec で75mmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで 、その上に、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)アル ミニウム-μ-オキソーピス(2-メチル-8-キノリノラ 一ト)アルミニウムと化合物(1-27)を、異なる蒸着源 から、蒸着速度 O. 2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着 (重量比100:2.0) し、発光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、蒸着速度0.2n m/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした 。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm /sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して 陰極とし、有機電界発光索子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光 素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ 、60mA/cm² の電流が流れた。輝度2010cd/m 2 の赤橙色の発光が確認された。

【0056】実施例17

厚さ200nmの1TO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10⁻⁶ Torr に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'ーピス [NーフェニルーNー(3"ーメークエニル)アミノ] ピフェニルを、蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ピス(2,4ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムーμーオキソーピス(2,4ージメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムと化合物(1-16)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/secで50nmで厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、発光層とした。次に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムを、蒸

depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 58 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1950 cd/m2 was verified.

[0055] Working Example 16

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, in ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N-phenyl-N-(3"-methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:2.0) it did bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - - oxo - bis (2 - methyl - 8 quinolinolato) aluminum and compound (1 - 27), in the thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 60 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 2010 cd/m2 was verified.

[0056] Working Example 17

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO transparent electrode (anode) of thickness 200 nm,making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr. First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4'-bis (N-phenyl-N-(3"-methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:4.0)it did bis (2,4-di methyl - 8-quinolinolato) aluminum - oxo-bis (2,4-di methyl

着速度 0.2 nm/sec で 50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、61 mA/cm²の電流が流れた。輝度 1970 c d/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0057】実施例18

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、4、4'ービス[NーフェニルーNー(3"ーメチル フェニル) アミノ] ピフェニルを、蒸着速度O. 2 nm/se c で75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウム と化合物(1-29)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0. 2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1 0) し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を蒸着速度O. 2nm/sec で2 00nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、 有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状 態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾 燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、58mA /cm² の電流が流れた。輝度1950cd/m² の赤橙色 | の発光が確認された。

【0058】実施例19

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'ーピス[NーフェニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ]ピフェニルを、蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い

- 8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 16), in the thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of the 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and the silver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor deposition tank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 61 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1970 cd/m2 was verified.

[0057] Working Example 18

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm making use of neutral detergent, acetone and ethanol, substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N-phenyl-N-(3"-methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:1.0) it did tris (8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 29), in thickness of 50 nm, it made theluminescent layer which combines electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 12V, current of 58 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1950 cd/m2 was verified.

[0058] Working Example 19

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm,making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4'- bis

で、その上に、1、1、4、4ーテトラフェニルー1、3ーブタジエンを、蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、トリス(8ーキノリノラート)アルミニウムと化合物(1-1)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/sec で200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、52mA/cm²の電流が流れた。輝度2270cd/m²の青色の発光が確認された。

【0059】実施例20

厚さ200mmの1T〇透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10⁻⁶ Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、4, 4'ーピス [NーフェニルーNー(3"ーメチル フェニル) アミノ] ピフェニルを、蒸着速度 O. 2 n m/se c で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次い で、その上に、化合物(1-14)を、蒸着速度 0.2 nm /sec で50nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、 その上に、1, 3ーピス〔5'ー(pーtertーブチルフェニ ル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル] ペンゼ ンを、蒸着速度 O. 2 nm/sec で 5 0 nmの厚さに蒸着し 、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと 銀を蒸着速度の、2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極とし、有機電界発光素子を作製 した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した 。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直 流電圧を印加したところ、49mA/cm2の電流が流れた 。輝度1990cd/m2の赤橙色の発光が確認された。

【0060】実施例21

厚さ200mmのIT〇透明電極(陽極)を有するガラス基

(N - phenyl- N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 - butadiene. inthe thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, on that, from vapor deposition source which differs, with vapor. deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 100:4. 0)it did tris (8 - quinolinolato) aluminum and compound (1 - 1), in thickness of 50 nm, made the electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver, in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 14V, current of 52 mA/cm2 flowed. light emission of blue of luminance 2270 cd/m2 was verified.

[0059] Working Example 2 0

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm making use of neutral detergent, acetone and ethanol. substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 4, 4' - bis (N - phenyl- N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl, in thickness of 75 nm, made positive hole injection transport layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did compound (1 - 14), in thickness of 50 nm, made luminescent layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 1,3 - bis (5'-(p - t-butyl phenyl) - 1,3,4 - oxadiazole -2'-yl) benzene, in thickness of 50 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and thesilver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 14V, current of 49 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1990 cd/m2 was verified.

[0060] Working Example 2 1

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra

板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸 着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極 上に、化合物 (1-10) を、蒸着速度 0.2 nm/secで 55nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に 、1, 3-ピス (5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1 , 3, 4-オキサジアゾール-2'-イル]ペンゼンを、蒸 着速度O. 2 nm/sec で75 nmの厚さに蒸着し、電子注 入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着 速度0. 2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比 10:1) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚 、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製し た有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を 印加したところ、68mA/cm2の電流が流れた。輝度1 150cd/m2の赤橙色の発光が確認された。

【0061】実施例22

厚さ200mmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリーN-ビニ ルカルパゾール (重量平均分子量150000)、1, 1, 4, 4ーテトラフェニルー1, 3ープタジエン(青色の発光 成分)、クマリン6〔"3-(2'-ペンゾチアゾリル)-**フージエチルアミノクマリン" (緑色の発光成分)]、およ** び化合物(1-5)を、それぞれ重量比100:5:3:2 の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、デ ィップコート法により、400nmの発光層を形成した。次 に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホル ダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。| さらに、発光層の上に、3-(4'-tertープチルフェニル) -4-フェニルー-5-(4"-ピフェニル)-1, 2, 4-トリアゾールを、蒸着速度 O. 2 nm/sec で 20 nm の厚さに蒸着した後、さらにその上に、トリス(8-キノリ ノラート)アルミニウムを、蒸着速度 O. 2 n m/sec で 3 Onmの厚さに蒸着し電子注入輸送層とした。さらにその上 に、マグネシウムと銀を蒸着速度 O. 2 n m/sec で 200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1) して陰極とし、有機 電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰 囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、74mA/c m² の電流が流れた。輝度1280cd/m² の白色の発光 が確認された。

nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm, making use of neutral detergent, acetone and ethanol, substrate was dried making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozoneafter washing, after locking in substrate holder of vapor deposition equipment, vapor deposition tankthe vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . First, on ITO transparent electrode, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did compound (1 -10), in the thickness of 55 nm, made luminescent layer. Next, on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did 1,3 - bis (5' - (p - t-butyl phenyl) - 1,3,4 oxadiazole -2'-yl) benzene, in thickness of 75 nm, made electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and the silver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 68 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1150 cd/m2 was verified.

[0061] Working Example 2 2

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm making use of neutral detergent, acetone and ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on ITO transparent electrode, luminescent layer of 400 nm was formed poly N - vinyl carbazole (weight average molecular weight 150000) and the 1.1.4.4 - tetra phenyl - 1.3 butadiene (light emission component of blue), making use of 3 wt% dichloroethane solution which contains the coumarin 6 ("3 -(2' - benzo thiazolyl) - 7-di ethylamino coumarin " (light emission component of green color)), and compound (1-5), at ratio of respective weight ratio 100:5:3:2, with dip coating method. Next, after locking glass substrate which possesses this luminescent layer, in substrate holderof vapor deposition equipment, vapor deposition tank vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . Furthermore, on luminescent layer, 3 - (4' - t-butyl phenyl) - 4 - phenyl - - 5 - (4" - biphenyl) - 1,2,4 - triazole, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec in thethickness of 20 nm vapor deposition after doing, furthermore on that, withthe vapor deposition rate 0.2 nm/sec vapor deposition it did tris (8 - quinolinolato) aluminum, in thickness of 30 nm andmade electron-implanted transport layer. Furthermore on that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and the silver in thickness of 200 nm, it made cathode, produced the organic electroluminescent element. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor depositiontank was maintained. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of

【0062】 実施例23

厚さ200mmのITO透明電極(隔極)を有するガラス基 板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄 した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オ ゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリーNービニ ルカルパゾール (重量平均分子量150000)、1,3-ピス〔5' - (p-tert-ブチルフェニル) - 1, 3, 4-オキサジアゾールー2'ーイル]ペンゼンおよび化合物(1 -35)を、それぞれ単量比100:30:3の割合で含有 する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート 法により、300mmの発光層を形成した。次に、この発光 層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定し た後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。さらに、発光 層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極と し、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素 子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、 76mA/cm² の電流が流れた。輝度1360cd/m² の赤橙色の発光が確認された。

【0063】比較例3

実施例23において、発光層の形成に際して、化合物(1-35)の代わりに、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエンを使用した以外は、実施例23に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、86mA/cm²の電流が流れた。輝度680cd/m²の青色の発光が確認された。

【0064】実施例24

厚さ200nmの1 T O透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、4,4'ービス [N-1] エニルーNー(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ビフェニル、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムにス(2ーメチルー8ーキノリノラート)アルミニウムおよび化合物(1ー7)を、それぞれ重量比100:40:60:1の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、300nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板を、蒸

12V, current of 74 mA/cm2 flowed. light emission of white of luminance 1280 cd/m2 was verified.

[0062] Working Example 2 3

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO tra nsparent electrode (anode) of thickness 200 nm making use of neutral detergent, acetone and ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on ITO transparent electrode, luminescent layer of 300 nm was formed making use of the poly N - vinyl carbazole (weight average molecular weight 150000), 1,3 - bis (5'-(p-tbutyl phenyl) - 1,3,4 - oxadiazole - 2'-yl) benzene and 3 wt% dichloroethane solution which contains compound (1 - 35), at ratio of respective weight ratio 100:30:3, with dip coating method. Next, after locking glass substrate which possesses this luminescent layer, in substrate holderof vapor deposition equipment, vapor deposition tank vacuum was done in 3 X 10-6 Torr . Furthermore, on luminescent layer, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and silver, in thickness of 200 nm, it made cathode, producedthe organic electroluminescent element. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 76 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1360 cd/m2 was verified.

[0063] Comparative Example 3

In Working Example 2 3, at time of formation of luminescent layer, other thanusing 1,1,4,4 - tetra phenyl - 1,3 - butadiene in place of compound (1 - 35), organic electroluminescent element was producedwith method which is stated in Working Example 2 3. In organic electric field element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 86 mA/cm2 flowed. light emission of blue of luminance 680 cd/m2 was verified.

[0064] Working Example 2 4

Ultrasonic cleaning it did glass substrate which possesses ITO transparent electrode (anode) of thickness 200 nm,making use of neutral detergent, acetone and ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on ITO transparent electrode, luminescent layer of 300 nm was formed polycarbonate (weight average molecular weight 50000) andthe 4, 4' - bis (N - phenyl - N - (3" - methylphenyl) amino) biphenyl, making use of bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum - oxo - bis (2 - methyl - 8 - quinolinolato) aluminum and 3 wt% dichloroethane solution which contains compound (1 - 7), atratio of respective weight ratio 100: 40: 60:1, with dip

着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10⁻⁶ Torr に減圧した。さらに、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加したところ、66mA/cm²の電流が 流れた。輝度1070cd/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0065】実施例25

ガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ガラス基板上に、化合物(1-1)を、蒸着速度O.2nm/secで100nmの厚さに蒸着した。その上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度O.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とした。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。その後、陰極上にスコッチテープを張り付けた後、スコッチテープを剥離したところ、陰極と共に、化合物(1-1)の薄膜もガラス基板から剥離し、陰極との密着力は良好であることが判明した。

[0066] 比較例4

実施例25において、化合物(1-1)の代わりに、1,3,5,7,8-ペンタメチルー4,4-ジフルオロー4ーポラー3a,4a-ジアザーsーインダセンを使用した以外は、実施例25に記載の方法により陰極を蒸着した薄膜を作製した。その後、陰極上にスコッチテープを張り付けた後、スコッチテープを剥離したところ、陰極と1,3,5,7,8ーペンタメチルー4,4-ジフルオロー4ーボラー3a,4a-ジアザーsーインダセンの薄膜の間で剥離し、陰極との密着力は不良であることが判明した。

[0067]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電界発 光索子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の1例(A)の概略構造図である

coating method. Next, after locking glass substrate which possesses this luminescent layer, in substrate holderof vapor deposition equipment, vapor deposition tank vacuum was done in 3 X 10-6 Torr. Furthermore, on luminescent layer, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesiumand silver, in thickness of 200 nm, it made cathode, producedthe organic electroluminescent element. In organic electroluminescent element which it produces, under dry atmosphere, when imparting itdoes direct current voltage of 15V, current of 66 mA/cm2 flowed. light emitting of reddish amber of brightness 1070 cd/m2 was verified.

[0065] Working Example 2 5

Ultrasonic cleaning it did glass substrate, making use of neutral d etergent, acetone and the ethanol. It dried substrate making use of nitrogen gas, furthermore UV/ ozonewashed. Next, on glass substrate, compound (1 - 1), with vapor deposition rate 0. 2 nm/sec vapor deposition was done in the thickness of 100 nm. On that, with vapor deposition rate 0.2 nm/sec codeposition (weight ratio 10:1) doing magnesium and silver, in the thickness of 200 nm, it made cathode. Furthermore vapor deposition executed while vacuum state of vapor deposition tank was maintained. after that, after attaching Scotch tape on cathode, the Scotch tape when it peels off, with cathode, also thin film of compound (1 - 1)peeled off from glass substrate, as for adhesive force of cathode beingsatisfactory was ascertained.

[0066] Comparative Example 4

In Working Example 2 5, other than using 1,3,5,7,8 - pentamet hyl - 4,4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza -s - indacene in place of compound (1 - 1), thin film which cathode vapor deposition isdone was produced with method which is stated in Working Example 2 5. after that, after attaching Scotch tape on cathode, the Scotch tape when it peels off, it peeled off between thin film of cathodeand 1,3,5,7,8 - pentamethyl - 4, 4-di fluoro - 4 - bora - 3a,4a-di aza - s - indacene, as for adhesive force ofthe cathode being a deficiency was ascertained.

[0067]

[Effects of the Invention] With this invention, it became possible to offer organic electroluminescent element where light emission luminance superior.

[Brief Explanation of the Drawing(s)]

[Figure 1] It is a outline structural diagram of 1 example (A) of organic electroluminescent element.

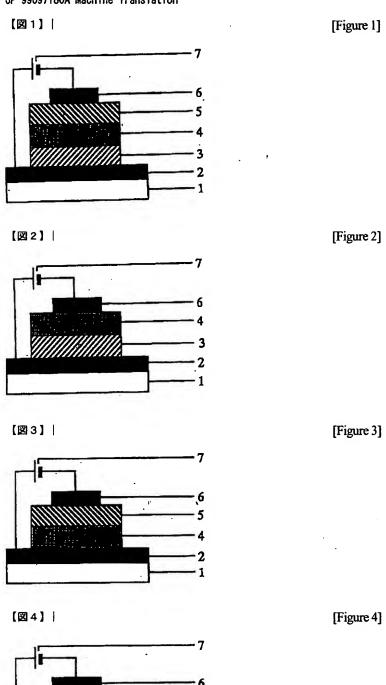
【図2】有機電界発光素子の1例(B)の概略構造図である [Figure 2] It is a outline structural diagram of 1 example (B) of o rganic electroluminescent element. 【図3】有機電界発光素子の1例(C)の概略構造図である [Figure 3] It is a outline structural diagram of 1 example (C) of o rganic electroluminescent element. 【図4】有機電界発光索子の1例(D)の概略構造図である [Figure 4] It is a outline structural diagram of 1 example (D) of organic electroluminescent element. 【図5】有機電界発光素子の1例(E)の概略構造図である [Figure 5] It is a outline structural diagram of 1 example (E) of o rganic electroluminescent element. 【図6】有機電界発光素子の1例(F)の概略構造図である [Figure 6] It is a outline structural diagram of 1 example (F) of o rganic electroluminescent element. 【図7】有機電界発光素子の1例(G)の概略構造図である [Figure 7] It is a outline structural diagram of 1 example (G) of o rganic electroluminescent element. 【図8】有機電界発光素子の1例(H)の概略構造図である [Figure 8] It is a outline structural diagram of 1 example (H) of organic electroluminescent element. 【符号の説明】 [Explanation of Reference Signs in Drawings] 1:基板 1: Substrate 2:陽極 2: Anode 3:正孔注入輸送層 3: Positive hole injection transport layer 3 a:正孔注入輸送成分 3a: Positive hole injection transport component 4:発光層 4: Luminescent layer 4 a: 発光成分 4a: Light emission component 5:電子注入輸送層 5: Electron-implanted transport layer 5":電子注入輸送層 5": Electron-implanted transport layer

5 a:電子注入輸送成分

7:電源

6: Cathode

5a: Electron injection transport component



THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-97180

(43)公開日 平成11年(1999)4月9日

H 0 5 B 33/14 B C 0 9 K 11/06 Z H 0 5 B 33/22 B
C 0 9 K 11/06 Z
H 0 5 B 33/22 B
·
D .
審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全 19]
(71)出題人 000005887
三井化学株式会社
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(72)発明者 西本 泰三
神奈川県横浜市柴区笠間町1190番地 三
東圧化学株式会社内
(72)発明者 三沢 伝美
神奈川県横浜市柴区笠間町1190番地 三
東圧化学株式会社内
(72) 発明者 杉本 賢一
神奈川県横浜市柴区笠間町1190番地 三
東圧化学株式会社内

(54)【発明の名称】 有機電界発光素子

(57)【要約】

【解決手段】 一対の電極間に、ベンゾピロメテン系化 合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【効果】 発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の電極間に、下記一般式(1)(化1)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、 少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。 【化1】

$$R_{10}$$
 R_{10}
 R_{10}
 R_{11}
 R_{10}
 R_{11}
 R_{11}
 R_{12}
 R_{12}
 R_{13}
 R_{14}
 R_{15}
 R_{15}

(式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 Rg はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シア ノ基、アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシア ルキル基、アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、ア リールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、 ジアルキルアミノカルボニル基、アルキルカルボニルア ミノ基、アリールカルボニルアミノ基、アリールアミノ カルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキ ル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、アル キルチオ基、アリールチオ基、アルケニルオキシカルボ ニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アルコキシカ ルボニルアルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル アルコキシカルボニル基、ジ (アルコキシアルキル) ア ミノカルボニル基、またはアルケニル基を表し、R。は 水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素 環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニ ル基を表し、R₁₀およびR₁₁はフッ素原子、アルキル 基、アルコキシ基、アラルキル基、炭素環式アリール 基、または複素環式アリール基を表す〕

【請求項2】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発光層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項3】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、電子注入輸送層である請求項1記載の有機電界発光素子。

【請求項4】 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、さらに発光性有機金属錯体を含有する請求項1~3のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項5】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送 層を有する請求項1~4のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【請求項6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送 層を有する請求項1~5のいずれかに記載の有機電界発 光素子。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子

に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バ ックライトなどのパネル型光源として使用されてきた が、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要 である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機 電界発光素子 (有機エレクトロルミネッセンス素子: 有 機EL素子)が開発された [Appl. Phys. Lett., 51、 913 (1987)〕。有機電界発光索子は、蛍光性有機化合物 を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、 該薄膜に電子および正孔 (ホール)を注入して、再結合 させることにより励起子 (エキシトン)を生成させ、こ の励起子が失活する際に放出される光を利用して発光す る素子である。有機電界発光素子は、数V~数十V程度 の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機 化合物の種類を選択することにより、種々の色(例え ば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このよう な特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、 表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、 一般に、発光輝度が低く、実用上充分ではない。 【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層 として、例えば、トリス (8-キノリノラート) アルミ ニウムをホスト化合物とし、クマリン誘導体、ピラン誘 導体をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電 界発光素子が提案されている [J. Appl. Phys., 65、 3610 (1989) 〕。また、発光層として、トリス(8-キ ノリノラート) アルミニウムをホスト化合物とし、ピロ メテン誘導体 (例えば、1,3,5,7,8-ペンタメ チルー4、4ージフルオロー4ーボラー3a,4aージ アザーs-インダセン)をゲスト化合物として用いた有 機電界発光素子が提案されている(特開平9-1188 80号公報)。しかしながら、該公報に記載されている ピロメテン誘導体を使用すると、発光色は緑ないし黄緑 色であり、また充分な発光輝度を有しているとは言い難 いことが判明した。さらには、特開平9-118880 号公報に記載されているピロメテン誘導体(例えば、 1,3,5,7,8-ペンタメチル-4、4-ジフルオ ロー4ーボラー3a, 4aージアザーsーインダセン) を含有する層と電極(例えば、陰極)との密着性は乏し く、長期間の使用に際しては、その改良が必要であるこ とが判明した。現在では、橙色ないし赤色に発光し、且 つ、高輝度に発光する有機電界発光素子が望まれてい

[0004]

る.

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光 効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供 することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界 発光索子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成する に至った。すなわち、本発明は、

① 一対の電極間に、下記一般式(1)(化2)で表される化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、

② 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、発 光層である①記載の有機電界発光素子、

③ 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、電子注入輸送層である②記載の有機電界発光素子、

④ 一般式(1)で表される化合物を含有する層が、さらに発光性有機金属錯体を含有する前記⑤ つつのいずれかに記載の有機電界発光素子、

⑤ 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記の~⑩のいずれかに記載の有機電界発光素子、

⑤ 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記の~⑤のいずれかに記載の有機電界発光素子、に関するものである。

[0006]

【化2】

〔式中、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_5 、 R_6 、 R_7 、 R_8 、 R。はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、シア ノ基、アルキル基、ハロゲノアルキル基、アルコキシア ルキル基、アルコキシ基、アルコキシアルコキシ基、ア リールオキシ基、アシル基、アルコキシカルボニル基、 ジアルキルアミノカルボニル基、アルキルカルボニルア ミノ基、アリールカルボニルアミノ基、アリールアミノ カルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アラルキ ル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、アル キルチオ基、アリールチオ基、アルケニルオキシカルボ ニル基、アラルキルオキシカルボニル基、アルコキシカ ルボニルアルコキシカルボニル基、アルキルカルボニル アルコキシカルボニル基、ジ (アルコキシアルキル) ア ミノカルボニル基、またはアルケニル基を表し、R4 は 水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素 環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニ ル基を表し、R₁₀およびR₁₁はフッ素原子、アルキル 基、アルコキシ基、アラルキル基、炭素環式アリール 基、または複素環式アリール基を表す〕

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、前記一般式(1)で表されるベンゾピロメテン系化合物を少なくとも1種含有する層を、少なくとも一層挟持し

てなるものである。前記一般式(1)で表されるベンゾ ピロメテン系化合物において、 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R₅、R₆、R₇、R₈、R₉はそれぞれ独立に、水素 原子、ハロゲン原子、シアノ基、アルキル基、ハロゲノ アルキル基、アルコキシアルキル基、アルコキシ基、ア ルコキシアルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、 アルコキシカルボニル基、ジアルキルアミノカルボニル 基、アルキルカルボニルアミノ基、アリールカルボニル アミノ基、アリールアミノカルボニル基、アリールオキ シカルボニル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、 複素環式アリール基、アルキルチオ基、アリールチオ 基、アルケニルオキシカルボニル基、アラルキルオキシ カルボニル基、アルコキシカルボニルアルコキシカルボ ニル基、アルキルカルボニルアルコキシカルボニル基、 ジ (アルコキシアルキル) アミノカルボニル基、または アルケニル基を表し、好ましくは、水素原子、アルキル 基、炭素環式アリール基を表す。

[0008] R_1 , R_2 , R_3 , R_5 , R_6 , R_7 , R8 およびR9 の具体例としては、水素原子;フッ素、塩 素、臭素、ヨウ素のハロゲン原子;シアノ基;例えば、 メチル基、エチル基、n-プロピル基、iso-プロピル基、 n-ブチル基、iso-ブチル基、sec-ブチル基、t-ブチル 基、n-ペンチル基、iso-ペンチル基、2-メチルブチル 基、1-メチルブチル基、neo-ペンチル基、1,2-ジメチル プロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、cyclo-ペンチル 基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチル基、3-メチルペン チル基、2-メチルペンチル基、1-メチルペンチル基、3, 3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチルブチル基、1,3-ジメ チルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、1,2-ジメチルブ チル基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1,2,2-トリメチル ブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1-エチル-2- メ チルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘプチル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、4-メチルヘキ シル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチルペンチル 基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2,5-ジメチル ヘキシル基、2,5,5-トリメチルペンチル基、2,4-ジメチ ルヘキシル基、2,2,4-トリメチルペンチル基、n-ノニル 基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、n-デシル基、4-エチ ルオクチル基、4-エチル-4,5- ジメチルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1,3,5,7-テトラメチルオ クチル基、4-ブチルオクチル基、6,6-ジエチルオクチル 基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブチルオクチル基、 n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3,5-ジメチルへ プチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジメチルヘプ チル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル基、1-cyclo-ペ ンチル-2,2- ジメチルプロピル基、1-cyclo-ヘキシル-2,2- ジメチルプロピル基等の直鎖、分岐または環状の アルキル基;

【0009】例えば、クロロメチル基、ジクロロメチル

基、フルオロメチル基、トリフルオロメチル基、ペンタ フルオロメチル基、ペンタフルオロエチル基、ノナフル オロブチル基等のハロゲノアルキル基;例えば、メトキ シエチル基、エトキシエチル基、iso-プロピルオキシエ チル基、3-メトキシプロピル基、2-メトキシブチル基等 のアルコキシアルキル基;例えば、メトキシ基、エトキ シ基、n-プロポキシ基、iso-プロポキシ基、n-ブトキシ 基、iso-ブトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基、 n-ペントキシ基、iso-ペントキシ基、neo-ペントキシ 基、n-ヘキシルオキシ基、n-ドデシルオキシ基等のア ルコキシ基:例えば、メトキシエトキシ基、エトキシエ トキシ基、3-メトキシプロピルオキシ基、3-(iso- プロ ピルオキシ) プロピルオキシ基等のアルコキシアルコキ シ基;例えば、フェノキシ基、2-メチルフェノキシ基、 4-メチルフェノキシ基、4-t-ブチルフェノキシ基、2-メ トキシフェノキシ基、4-iso-プロピルフェノキシ基等の アリールオキシ基;例えば、ホルミル基、アセチル基、 エチルカルボニル基、nープロピルカルボニル基、isoープ ロピルカルボニル基、n-ブチルカルボニル基、iso-ブチ ルカルボニル基、sec-ブチルカルボニル基、t-ブチルカ ルボニル基、n-ペンチルカルボニル基、iso-ペンチルカ ルボニル基、neo-ペンチルカルボニル基、2-メチルブチ ルカルボニル基、ニトロベンジルカルボニル基等のアシ ル基; 例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボ ニル基、イソプロピルオキシカルボニル基、2,4-ジメチ ルブチルオキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル 基;

【0010】例えば、ジメチルアミノカルボニル基、ジ エチルアミノカルボニル基、ジ-n- プロビルアミノカル ボニル基、ジ-n- ブチルアミノカルボニル基、N-メチル -N- シクロヘキシルアミノカルボニル基等のジアルキル アミノカルボニル基: 例えば、アセチルアミノ基、エチ ルカルボニルアミノ基、ブチルカルボニルアミノ基等の アルキルカルボニルアミノ基;例えば、フェニルアミノ カルボニル基、4-メチルフェニルアミノカルボニル基、 2-メトキシフェニルアミノカルボニル基、4-n-プロピル フェニルアミノカルボニル基等のアリールアミノカルボ ニル基;例えば、フェニルカルボニルアミノ基、4-エチ ルフェニルカルボニルアミノ基、3-ブチルフェニルカル ボニルアミノ基等のアリールカルボニルアミノ基:例え ば、フェノキシカルボニル基、2-メチルフェノキシカル ボニル基、4-メトキシフェノキシカルボニル基、4-t-ブ チルフェノキシカルボニル基等のアリールオキシカルボ ニル基:例えば、ベンジル基、ニトロベンジル基、シア ノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベンジル 基、ジメチルベンジル基、トリメチルベンジル基、ジク ロロベンジル基、メトキシベンジル基、エトキシベンジ ル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチルメチル 基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル 基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメチ ル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基等のアラル キル基:

【0011】例えば、フェニル基、ニトロフェニル基、 シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェ ニル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、 ジクロロフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフ ェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、N,N-ジメチ ルアミノフェニル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、 シアノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフ チル基、トリフルオロメチルナフチル基等の炭素環式ア リール基:例えば、ピロリル基、チエニル基、フラニル 基、オキサゾイル基、イソオキサゾイル基、オキサジア ゾイル基、イミダゾイル基、ベンゾオキサゾイル基、ベ ンゾチアゾイル基、ベンゾイミダゾイル基、ベンゾフラ ニル基、インドイル基等の複素環式アリール基:例え ば、メチルチオ基、エチルチオ基、n-プロピルチオ基、 iso-プロピルチオ基、n-ブチルチオ基、iso-ブチルチオ 基、sec-ブチルチオ基、t-ブチルチオ基、n-ペンチルチ オ基、iso-ペンチルチオ基、2-メチルブチルチオ基、1-メチルブチルチオ基、neo-ペンチルチオ基、1,2-ジメチ ルプロビルチオ基、1,1-ジメチルプロビルチオ基等のア ルキルチオ基;例えば、フェニルチオ基、4-メチルフェ ニルチオ基、2-メトキシフェニルチオ基、4-t-ブチルフ ェニルチオ基等のアリールチオ基:例えば、アリルオキ シカルボニル基、2-ブテノキシカルボニル基等のアルケ ニルオキシカルボニル基;例えば、ベンジルオキシカル ボニル基、フェネチルオキシカルボニル基等のアラルキ ルオキシカルボニル基;

【0012】例えば、メトキシカルボニルメトキシカル ボニル基、エトキシカルボニルメトキシカルボニル基、 n-プロポキシカルボニルメトキシカルボニル基、イソポ ウロポキシカルボニルメトキシカルボニル基等のアルコ キシカルボニルアルコキシカルボニル基;例えば、メチ ルカルボニルメトキシカルボニル基、エチルカルボニル メトキシカルボニル基等のアルキルカルボニルアルコキ シカルボニル基: 例えば、ジ(メトキシエチル) アミノ カルボニル基、ジ (エトキシメチル) アミノカルボニル 基、ジ (エトキシエチル) アミノカルボニル基、ジ (プ ロボキシエチル) アミノカルボニル基等のジ (アルコキ シアルキル) アミノカルボニル基; 例えば、ビニル基、 プロペニル基、1-ブテニル基、iso-ブテニル基、1-ペン テニル基、2-ペンテニル基、2-メチル-1- ブテニル基、 3-メチル-1- ブテニル基、2-メチル-2- ブテニル基、2, 2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2- メチルカルボキシル ビニル基、2-シアノ-2- メチルスルホンビニル基等のア ルケニル基を挙げることができる。

【0013】R4は水素原子、シアノ基、アルキル基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリール基、またはアルケニル基を表し、好ましくは、水素原子、アルキル基を表す。R4の具体例としては、水素原

子;シアノ基;例えば、メチル基、エチル基、n-プロピ ル基、iso-プロピル基、n-ブチル基、iso-ブチル基、se c-ブチル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、iso-ペンチル 基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、neo-ペンチ ル基、1,2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル 基、cyclo-ペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチ ル基、3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メ チルペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチル ブチル基、1,3-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブチル 基、1,2-ジメチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル 基、1,2,2-トリメチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチ ル基、1-エチル-2- メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル 基、n-ヘプチル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキ シル基、4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2, 4-ジメチルペンチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシ ル基、2,5-ジメチルヘキシル基、2,5,5-トリメチルペン チル基、2,4-ジメチルヘキシル基、2,2,4-トリメチルペ ンチル基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、 n-デシル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4,5- ジメ チルヘキシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1.3. 5,7-テトラメチルオクチル基、4-ブチルオクチル基、6. 6-ジエチルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4-ブチルオクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル 基、3,5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル 基、2,4-ジメチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルへ キシル基、1-cyclo-ペンチル-2,2- ジメチルプロピル 基、1-cyclo-ヘキシル-2,2- ジメチルプロピル基等の直 鎖、分岐または環状のアルキル基;

【0014】例えば、ベンジル基、ニトロベンジル基、 シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベン ジル基、ジメチルベンジル基、トリメチルベンジル基、 ジクロロベンジル基、メトキシベンジル基、エトキシベ ンジル基、トリフルオロメチルペンジル基、ナフチルメ チル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチ ル基、ヒドロキシナフチルメチル基、メチルナフチルメ チル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基等のアラ ルキル基:例えば、フェニル基、ニトロフェニル基、シ アノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニ ル基、ジメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、ジ クロロフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェ ニル基、トリフルオロメチルフェニル基、N,N-ジメチル アミノフェニル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、シ アノナフチル基、ヒドロキシナフチル基、メチルナフチ ル基、トリフルオロメチルナフチル基等の炭素環式アリ ール基;ピロリル基、チエニル基、フラニル基、オキサ ゾイル基、イソオキサゾイル基、オキサジアゾイル基、 イミダゾイル基、ベンゾオキサゾイル基、ベンゾチアゾ イル基、ベンゾイミダゾイル基、ベンゾフラニル基、イ ンドイル基等の複素環式アリール基:例えば、ビニル

基、プロペニル基、1-ブテニル基、iso-ブテニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテニル基、2-メチル-1-ブテニル基、3-メチル-1-ブテニル基、2-メチル-2-ブテニル基、2.2-ジシアノビニル基、2-シアノ-2-メチルカルボキシルビニル基、2-シアノ-2-メチルスルホンビニル基等のアルケニル基を挙げることができる。

【0015】 R_{10} および R_{11} はフッ素原子、アルキル 基、アラルキル基、炭素環式アリール基、複素環式アリ ール基、またはアルコキシ基を表し、好ましくは、フッ 素原子を表す。 R_{10} および R_{11} の具体例としては、フッ 素原子; 例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、 iso-プロピル基、n-ブチル基、iso-ブチル基、sec-ブチ ル基、t-ブチル基、n-ペンチル基、iso-ペンチル基、2-メチルブチル基、1-メチルブチル基、neo-ペンチル基、 1,2-ジメチルプロピル基、1,1-ジメチルプロピル基、cy clo-ペンチル基、n-ヘキシル基、4-メチルペンチル基 3-メチルペンチル基、2-メチルペンチル基、1-メチルペ ンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2,3-ジメチルブチル 基、1,3-ジメチルブチル基、2,2-ジメチルブチル基、1. 2-ジメチルブチル基、1,1-ジメチルブチル基、3-エチル ブチル基、2-エチルブチル基、1-エチルブチル基、1,2, 2-トリメチルブチル基、1,1,2-トリメチルブチル基、1-エチルー2- メチルプロピル基、cyclo-ヘキシル基、n-ヘ プチル基、2-メチルヘキシル基、3-メチルヘキシル基、 4-メチルヘキシル基、5-メチルヘキシル基、2,4-ジメチ ルペンチル基、n-オクチル基、2-エチルヘキシル基、2, 5-ジメチルヘキシル基、2,5,5-トリメチルペンチル基、 2,4-ジメチルヘキシル基、2,2,4-トリメチルペンチル 基、n-ノニル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、n-デシ ル基、4-エチルオクチル基、4-エチル-4.5- ジメチルへ キシル基、n-ウンデシル基、n-ドデシル基、1,3,5,7-テ トラメチルオクチル基、4-ブチルオクチル基、6.6-ジェ チルオクチル基、n-トリデシル基、6-メチル-4- ブチル オクチル基、n-テトラデシル基、n-ペンタデシル基、3、 5-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチルヘプチル基、2,4-ジメチルヘプチル基、2,2,5,5-テトラメチルヘキシル 基、1-cyclo-ペンチル-2,2- ジメチルプロピル基、1-cy clo-ヘキシル-2,2- ジメチルプロビル基等の直鎖、分岐 または環状のアルキル基;

【0016】例えば、メトキシ基、エトキシ基、n-プロボキシ基、iso-プロボキシ基、n-ブトキシ基、iso-プトキシ基、sec-ブトキシ基、t-ブトキシ基、n-ペントキシ基、iso-ペントキシ基、n-ペントキシ基、n-ペントキシ基、n-ペントキシ基;例えば、ベンジル基、ニトロベンジル基、シアノベンジル基、ヒドロキシベンジル基、メチルベンジル基、ジメチルベンジル基、トリメチルベンジル基、ジクロロベンジル基、メトキシベンジル基、トリフルオロメチルベンジル基、ナフチルメチル基、ニトロナフチルメチル基、シアノナフチルメチル基、ヒドロキ

シナフチルメチル基、メチルナフチルメチル基、トリフルオロメチルナフチルメチル基等のアラルキル基:例えば、フェニル基、ニトロフェニル基、シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、メチルフェニル基、ジクロロフェニル基、メトキシフェニル基、エトキシフェニル基、トリフルオロメチルフェニル基、N,Nージメチルアミノフェニル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、ナフチル基、ニトロナフチル基、シアノナフチル基、トリフルオロメチルナフチル基等の炭素環式アリール基:ピロリル基、チエニル基、フラニル基、オキサゾイル基、イソオキサゾイル基、オキサジアゾイル基、イミダゾイル基、ベンゾオキサゾイル基、ベンゾチアゾイル基、ベンゾイミダゾイル基、ベンブフラニル基、インドイル基等の複素環式アリール基を挙げることができる。

【0017】本発明の一般式(1)で示されるベンゾピロメテン化合物は、其自体公知の方法に従って製造することができる。例えば、Journal of Chemical Society、Chemical Communication、1994、1129-1130に記載の方法に従い製造される一般式(2)(化3)で示される化合物と、三フッ化ホウ素類とを反応させて、一般式(3)(化3)で示される化合物を製造した後、フッ素原子を置換して一般式(1)で示されるベンゾピロメテン化合物を合成する。

【0018】 【化3】

(上式中、 $R_1 \sim R_9$ は前記に同じ。)本発明に用いられる一般式(1)で示されるベンゾピロメテン化合物の具体例としては、例えば、第1表(表 $1\sim3$)に示す化合物を挙げることができるが、本発明はこれらの例示化合物に限定されるものではない。

【0019】 【表1】

化合物	ď	æ	æ	æ	ď	æ	de.	æ	æ	æ	ď
1-1	£,	ጟ፟	ช์	I	Ŧ	Ŧ	I	Ŧ	P	L	"
1.2	ર્ફ	I	ਣੰ	I	I	I	Ť	I	P	, tL	L
£.	ਨੂੰ	I	ર્ક	I	I	I	I	I	OOG!	ı.	Ŀ
1-4	8	ಈ, (೧ ಗ್ಯ)2 ೦ಗ(೧ಗ್ಯ)2 ೧ಗ್ಯ	2)2 CH3	Ξ	I	I	x	Ŧ	\$0 ♦	u.	Œ
10	I	Ĭ,	ž ď	I	I	I	I	I	±°	LL !	ш
9	ජි	1 5	કૈં	I	I	t-Bu	t-Bu		P	L	ш,
1.7	ಕੰ	Ť,	r S	I	I	x		I	క	ш	ш
œ	P	I	P	I	I	I	x	I	I	. ц	
œ,	కో	t-Bu	ទ័	I	r	I	x	I	\$	u.	IL.
1-10	Ŷ	I	ช้	r	I	I	I	I	\ <u>i</u>	ŭ.	Œ
1:1	ਤੰ	ť	P	I	I	I	I	I	P P	u.	. L
1-12	ર્કેં	ર્ફ		ਝੰ	I	I	I	I	¥ 🗘	u.	IL.
1-13	I	ર્ક	I	r	I	I	I	I	Ŷ	u.	Ŀ
1-14	I	t-Bu	I	I	ර ්	ર્ફ	ર્દ	కో	ç	щ	L

[0020]

【表2】

第1表	表 (つづき)	(¥									
化合物	ď	æ	æ	œ	æ	æ	æ	æ	æ	P ₄ o	3.
1-18	₩25°®	n-C ₈ H ₁₃	₩Ç.W	Ξ	I	I	SQ-t-Bu	I	ጜ	u.	L
1.18	_{රී}	оод. 3	P	8	§.	ğ	ğ	ę,	I	9	LL.
1-17	కో	۵	±°	I	I	I	ō	I	¢	n-C ₈ H ₁₁	n-C ₈ H ₁₁
1-18		I	I	8	I	I	I	I) 458	CH2)2 CH(CH3)	12 (CH ₂)2CH(CH ₃)2
1.18	& &	യൂഷുതുഷ്യ	£	I	I	I	I	I	Ċ	L	L.
1-20	ş	కో	±°	I	#28	95. F	002 H.	8 ¥	8	L	u.
1-21	Ç	ર્ક	ฮ์	క	I	I	· I	I	¥20	L	ш
1-22	-9.1Bu	ō	ō	I	I	t-Bu	t-Bu	I	Ŷ	Çz	IL.
1-23	ธ์	n-C,He	I	9	I	I	I	I	.	క్	8
1-24	ช้	O~O+Bu	ર્દ	Ŷ	r	x	r	ı	®,cH=CH	L.	La.
1-26	₹;	80°H	I	ઠ	I	i-Bu	t-Bu	I	82.0	ш	Ŷ
1.26	් ජ්	CONH(CH ₃) ₂	I	\$ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	I P	Ŷ	Ŷ	I	യൂവുതൽ, ԻԳԱ	5 P-C ₆ H ₁₁	n-C ₆ H ₁₁
1-27	%ರೆ. ೧೩೯೩	NHCOC2H ₆	క	© I	ទ័	ર્કેં	క	ર્ફ	Ŷ	u	(CH ₂) ₂ CH(CH ₃) ₂
1-28	ਨੰ	Q -co+N	ਣੰ	I	I	r	I	Ŧ	(E)	L.	u.

[0021]

合物	Œ	æ	æ	æ	æ	æ	æ	æ	ھے	£	æ
1.29	కో	O	ર્ક	**************************************	Ξ	I	I	I	Q teu	8	u
1-30	9	-S∕-t-Bu	ર્ક	ΙI	I	Ι	I	I	•	PC3H11	nC ₈ H
1-31	ธ์	&. •	ਲੌਂ	I	Ø	٥	۵	٥	t-Bu	₹°	2 0
1-32	కో	Q-HNOO	ફુ	, x	I	I	x	I	Ŷ	_	⊕
1.33	ਲੂ ਨੂ	ጟ፟	ਲੌ	2 2 2 3	I	I	I	I	\$		Ç
1-34	2.5°	CON(CH2OCH3)2	ર્કે	ક	I	I	I	. I	\$ 1 5	u	u.
1-35	₽ ₂ 00%	Q 88	ਝੰ	I	I	ģ	8	I	9	u.	L.
1-36	ಕೆ	œ G G G	Ţ	I	8	8	8	8	We Per	Ŀ	L

【0022】有機電界発光素子は、通常、一対の電極間に、少なくとも1種の発光成分を含有する発光層を、少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する正孔注入輸送層または/および電子注入輸送層を設けることもできる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能または/および電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層または/および電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸

送層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子(一層型の素子)の構成とすることもできる。また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。

【0023】本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、前記一般式(1)で表される化合物を少なくとも 1種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子である。本発明の有機電界発光素子において、一般式(1)で表される化合物は、正孔注入輸送成 分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、発光成分または電子注入輸送成分に用いることがより好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、一般式(1)で表される化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0024】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図1)、(B)陽極/正孔注入輸送層/発光層/陰極型素子(図2)、(C)陽極/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子(図3)、(D)陽極/発光層/陰極型素子(図4)などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である(E)陽極/正孔注入輸送層/電子注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/降極型素子(図5)とすることもできる。

(D)型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子は勿論であるが、さらには、例えば、(F)正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図6)、(G)正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図7)、または(H)発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一対の電極間に挟持させた型の素子(図8)がある。

【0025】本発明の有機電界発光素子は、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層または/および発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、(A)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(E)型素子、(G)型素子、は(H)型素子、(C)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(C)型素子、(B)型素子、(C)型素子、(B)型素子。(C)型素子、(B)型素子。(C)型素子、(B)型素子。(C)型素子、(B)型素子。(C)型素子、(B)型素子。(C)型素子、(B)型素子。(C)型素子、(C)型素子。(E)型素子または(H)型素子である。

【0026】本発明の有機電界発光素子としては、例えば、(図1)に示す(A)陽極/正孔注入輸送層/発光層/電子注入輸送層/陰極型素子について説明する。

(図1)において、1は基板、2は陽極、3は正孔注入 輸送層、4は発光層、5は電子注入輸送層、6は陰極、 7は電源を示す。

【0027】本発明の有機電界発光素子は、基板1に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート (例えば、ボリエステル、ボリカーボネート、ボリスルフォン、ボリメチルメタアクリレート、ボリプロピレン、ボリエチレンなどのシート)、半透明プラスチック

シート、石英、透明セラミックス、あるいは、これらを 組み合わせた複合シートからなるものを挙げることがで きる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、 色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせて、発光色をコン トロールすることもできる。

【0028】陽極2としては、比較的仕事関数の大きい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陽極に使用する電極物質として は、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、 パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化 亜鉛、ITO (インジウム・ティン・オキサイド)、ポ リチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができ る。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、ある いは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質 を、例えば、蒸着法、スパッタリング法等の方法によ り、基板の上に形成することができる。また、陽極は一 層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよ い。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百Ω/□ 以下、より好ましくは、5~50 Ω/□程度に設定す る。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよる が、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、 10~500nm程度に設定する。

【0029】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔(ホール)の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、本発明に係る一般式(1)で表される化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物および/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物(例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾン誘導体、ポリシラン誘導体、ボリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ボリチオフェンおよびその誘導体、ボリチオフェンおよびその誘導体、ボリービニルカルバゾール誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

ナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミ ノ) -6-フェニルフェナントリジン、4-メチルー N, N-ピス (4", 4''' -ピス(N', N' -ジ (4-メチルフェニル) アミノ] ビフェニルー4ーイ ル] アニリン、N, N'ービス [4-(ジフェニルアミ ノ)フェニル] -N, N' -ジフェニル-1, 3-ジア ミノベンゼン、N, N'-ビス [4-(ジフェニルアミ ノ)フェニル〕-N,N'-ジフェニル-1,*4-ジア* ミノベンゼン、5,5"ービス〔4-(ビス[4-メチ ルフェニル] アミノ) フェニル] -2, 2':5', 2"-ターチオフェン、1,3,5-トリス(ジフェニ ルアミノ) ベンゼン、4,4',4"-トリス (N-カ ルバゾリル) トリフェニルアミン、4,4',4"ート リス (N-(3''' -メチルフェニル) -N-フェニル アミノ〕トリフェニルアミン、1,3,5-トリス(N - (4'-ジフェニルアミノフェニル)フェニルアミ ノ〕ベンゼンなど)、ポリチオフェンおよびその誘導 体、ポリーNービニルカルバゾール誘導体がより好まし い。本発明において、一般式(1)で表される化合物と 他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、 正孔注入輸送層中に占める一般式(1)で表される化合 物の割合は、好ましくは、0.1~40重量%程度に調

【0031】発光層4は、正孔および電子の注入機能、 それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を 生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発 光層は、一般式(1)で表される化合物および/または 他の発光機能を有する蛍光性化合物(例えば、アクリド ン誘導体、キナクリドン誘導体、多環芳香族化合物〔例 えば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、 ペリレン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラ フェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロペ ンタジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9, 10-ビス (フェニルエチニル) アントラセン、1,4 ービス (9' ーエチニルアントラセニル) ベンゼン、 4, 4'ービス(9"ーエチニルアントラセニル) ビフ ェニル〕、トリアリールアミン誘導体〔例えば、正孔注 入輸送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げ ることができる〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8 ーキノリノラート) アルミニウム、ビス (10-ベンゾ [h] キノリノラート) ベリリウム、2-(2'-ヒドロ キシフェニル)ベンゾオキサゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛 塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩〕、スチルベン 誘導体〔例えば、1,1,4,4-テトラフェニルー 1, 3-ブタジエン、4, 4'ービス(2, 2ージフェ ニルビニル)ビフェニル〕、クマリン誘導体〔例えば、 クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、 クマリン106、クマリン138、クマリン151、ク マリン152、クマリン153、クマリン307、クマ

リン311、クマリン314、クマリン334、クマリン338、クマリン343、クマリン500〕、ピラン誘導体〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘導体〔例えば、ナイルレッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリーNービニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリテエニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリナスニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することができる。

【0032】本発明の有機電界発光素子においては、発光層に一般式(1)で表される化合物を含有していることが好ましい。一般式(1)で表される化合物と他の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める一般式(1)で表される化合物の割合は、好ましくは、0.001~99.99重量%程度、より好ましくは、0.01~99.99重量%程度、さらに好ましくは、0.1~99.9重量%程度に調製する。

【0033】本発明において用いる他の発光機能を有する化合物としては、発光性有機金属錯体がより好ましい。例えば、J. Appl. Phys., 65、3610 (1989)、特開平5-214332号公報に記載のように、発光層をホスト化合物とゲスト化合物(ドーパント)とより構成することもできる。一般式(1)で表される化合物を、ホスト化合物として用いて発光層を形成することができるには、ゲスト化合物として用いて発光層を形成する場合、ホスト化合物として用いて発光層を形成する場合、ホスト化合物としては、発光性有機金属錯体が好ましい。この場合、発光性有機金属錯体に対して、一般式(1)で表される化合物を、好ましくは、0.001~40重量%程度、より好ましくは、0.01~30重量%程度、特に好ましくは、0.1~10重量%程度使用する。

【0034】一般式(1)で表される化合物と併用する発光性有機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の8-キノリノラート配位子を有する発光性有機アルミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機企属錯体としては、例えば、一般式(a)~一般式(c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることができる。

$$(Q)_3 - A1 \qquad (a)$$

(式中、Qは置換または未置換の8-キノリノラート配位子を表す)

(式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表し、O

-Lはフェノラート配位子であり、Lはフェニル部分を 含む炭素数6~24の炭化水素基を表す) $(Q)_2 - A1 - O - A1 - (Q)_2$ (c) (式中、Qは置換8-キノリノラート配位子を表す) 【0035】発光性有機金属錯体の具体例としては、例 えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム、ト リス (4-メチル-8-キノリノラート) アルミニウ ム、トリス (5-メチル-8-キノリノラート) アルミ ニウム、トリス(3,4-ジメチル-8-キノリノラー ト) アルミニウム、トリス(4,5-ジメチルー8ーキ ノリノラート) アルミニウム、トリス(4,6-ジメチ ル-8-キノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メ チル-8-キノリノラート) (フェノラート) アルミニ ウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス (2ーメチル -8-キノリノラート)(3-メチルフェノラート)ア ルミニウム、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラート) (4-メチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2-フェニルフェノラ ート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノ ラート) (3-フェニルフェノラート) アルミニウム、 【0036】ビス(2-メチル-8-キノリノラート) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス(2 -メチル-8-キノリノラート)(2,3-ジメチルフ ェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キ ノリノラート) (2,6ージメチルフェノラート) アル ミニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート) (3, 4-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ピス (2-メチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチ ルフェノラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8 ーキノリノラート) (3,5-ジ-tert-ブチルフェノ ラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリ ノラート)(2,6-ジフェニルフェノラート)アルミ ニウム、ビス(2ーメチルー8ーキノリノラート) (2, 4, 6-トリフェニルフェノラート) アルミニウ ム、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(2, 4,6-トリメチルフェノラート)アルミニウム、ビス (2-x+v-8-+1)/(2,4,5,6)ーテトラメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2 ーメチルー8-キノリノラート)(1-ナフトラート) アルミニウム、ビス (2-メチル-8-キノリノラー ト) (2-ナフトラート) アルミニウム、ビス(2,4 ージメチルー8ーキノリノラート)(2ーフェニルフェ ノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチルー8 ーキノリノラート) (3-フェニルフェノラート) アル こ ミニウム、ビス (2, 4ージメチルー8ーキノリノラー ト) (4-フェニルフェノラート) アルミニウム、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジメチルフェノラート) アルミニウム、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)(3,5-ジーtertブチルフェノラート) アルミニウム、

【0037】ビス(2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムールーオキソーピス (2-メチルー8-キ ノリノラート) アルミニウム、ビス(2,4ージメチル -8-キノリノラート) アルミニウム-μ-オキソービ ス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニ ウム、ビス(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラ ート) アルミニウムーμーオキソービス (2-メチルー 4-エチル-8-キノリノラート) アルミニウム、ピス (2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)ア ルミニウムーμーオキソービス(2-メチルー4-メト キシー8ーキノリノラート) アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート) アルミニウ ムールーオキソービス(2-メチルー5-シアノー8-キノリノラート) アルミニウム、ピス (2-メチルー5 ートリフルオロメチルー8ーキノリノラート)アルミニ ウムールーオキソービス (2-メチルー5-トリフルオ ロメチルー8-キノリノラート) アルミニウムなどを挙 げることができる。勿論、発光性有機金属錯体は、単独 で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。 【0038】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注

入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する 機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送 層は、一般式(1)で表される化合物および/または他 の電子注入輸送機能を有する化合物(例えば、有機金属 錯体 (例えば、トリス (8-キノリノラート) アルミニ ウム、ビス (10-ベンゾ(h) キノリノラート) ベリリ ウム)、オキサジアゾール誘導体、トリアゾール誘導 体、トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導 体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニ トロ置換フルオレノン誘導体、チオピランジオキサイド 誘導体など)を少なくとも1種用いて形成することがで きる。本発明の有機電界発光素子においては、電子注入 輸送層に、一般式 (1)で表される化合物を含有してい ることが好ましい。一般式(1)で表される化合物と他 の電子注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、電 子注入輸送層中に占める本発明に係る一般式(1)で表 される化合物の割合は、好ましくは、0.1重量%以 上、より好ましくは、0.1~40重量%程度、さらに 好ましくは、0.2~30重量%程度、特に好ましく は、0.5~20重量%程度に調製する。本発明におい ては、一般式(1)で表される化合物と有機金属錯体 〔例えば、前記一般式 (a) ~一般式 (c) で表される 化合物〕を併用して、電子注入輸送層を形成することは 好ましい。

【0039】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい 金属、合金または電気電導性化合物を電極物質として使 用することが好ましい。陰極に使用する電極物質として は、例えば、リチウム、リチウムーインジウム合金、ナ トリウム、ナトリウムーカリウム合金、カルシウム、マ グネシウム、マグネシウムー銀合金、マグネシウムーインジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウムーリチウム合金、アルミニウムーマグネシウム合金、グラファイト薄膜等を挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0040】陰極は、これらの電極物質を、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン化素着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法等の方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百Ω/□以下に設定するのが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000 nm程度、より好ましくは、10~500 nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0041】また、本発明の有機電界発光素子において は、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャー が含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとし ては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、 ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げ られ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素ク エンチャーが含有されている層としては、特に限定する ものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸 送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。 尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項酸素クエンチャー を含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させ てもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光 層、発光機能を有する電子注入輸送層) の近傍に含有さ せてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量として は、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成す る全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.0 5~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量% である。

【0042】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例えば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・ブロゼット法など)により薄膜を形成することにより作製することができる。真空蒸着法により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、10-5 Torr 程度以下の真空下で、50~400℃程度のボート温度(蒸着源温度)、-50~300℃程度の基板温度で、0.005~50nm/sec 程度の蒸着速

度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層は、真空下で、連続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電界発光素子を製造することができる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層等の各層を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ボートを個別に温度制御して、共蒸着することが好ましい。

【0043】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正 孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用し うるバインダー樹脂としては、例えば、ポリーNービニ ルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリ エステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、 ポリメチルメタアクリレート、ポリエーテル、ポリカー ボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミ ド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレン オキサイド、ポリエーテルスルフォン、ポリアニリンお よびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポ リフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレ ンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびそ の誘導体等の高分子化合物が挙げられる。バインダー樹 脂は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用しても よい。

【0044】溶液塗布法により、各層を形成する場合、 各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂 等を、適当な有機溶媒(例えば、ヘキサン、オクタン、 デカン、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メ チルナフタレン等の炭化水素系溶媒、例えば、アセト ン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シ クロヘキサノン等のケトン系溶媒、例えば、ジクロロメ タン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエ タン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロ ベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエン等のハロ ゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチ ル、酢酸アミル等のエステル系溶媒、例えば、メタノー ル、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサ ノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチ ルセロソルブ、エチレングリコール等のアルコール系溶 媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、 ジオキサン、アニソール等のエーテル系溶媒、例えば、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1,3-ジメ チルー2-イミダゾリジノン、 ジメチルスルフォキサイ ド等の極性溶媒)および/または水に溶解、または分散 させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成す ることができる。

【0045】尚、分散する方法としては、特に限定する ものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペ イントシェーカー、アトライター、ホモジナイザー等を 用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度 に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布 法により、所望の厚みを作製するに適した濃度範囲に設 定することができ、一般には、0.1~50重量%程度 度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度であ る。尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に 関しては、特に限定するものではないが、一般には、各 層を形成する成分に対して(一層型の素子を形成する場 合には、各成分の総量に対して)、5~99.9重量% 程度、好ましくは、10~99重量%程度、より好まし くは、15~90重量%程度に設定する。

【0046】正孔注入翰送層、発光層、電子注入翰送層 の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般 に、5 n m~5 μ m程度に設定することが好ましい。 尚、作製した素子に対し、酸素や水分等との接触を防止 する目的で、保護層(封止層)を設けたり、また素子 を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオ イル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカ ーボン油などの不活性物質中に封入して保護することが できる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機 高分子材料(例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シ リコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレ ン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポ リイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリ エチレン、ポリフェニレンオキサイド)、無機材料(例 えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶 縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化物、 金属硫化物)、さらには光硬化性樹脂などを挙げること ができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよ く、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造 であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0047】また、電極に保護膜として、例えば、金属酸化膜(例えば、酸化アルミニウム膜)、金属フッ化膜を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアニン誘導体から成る界面層(中間層)を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0048】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。 尚、印加電圧は、一般に、2~30V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

[0049]

【実施例】以下、実施例により本発明をさらに詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらに限定されるものでは

ない。

実施例1

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス〔Nーフェ ニル-N-(1"-ナフチル)アミノ〕 ピフェニルを、 蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、 正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8 ーキノリノラート)アルミニウムと第1表に示す化合物 (1-1) (以下、同じ)を、異なる蒸着源から、蒸着 速度0.2 nm/sec で50 nmの厚さに共蒸着 (重量 比100:0.5)し、発光層とした。次に、トリス (8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0. 2 nm/sec で50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送 層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速 度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量 比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製し た。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し た。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、58mA/cm²の電 流が流れた。輝度2240cd/m²の赤橙色の発光が 確認された。

【0050】実施例2~14

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用する代わりに、化合物(1-2~1-14)を使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、赤橙色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表(表4)に示した。

【0051】比較例1

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用せずに、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムだけを用いて、50nmの厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表に示した。【0052】比較例2

実施例1において、発光層の形成に際して、化合物(1-1)を使用する代わりに、1,3,5,7,8-ペンタメチル-4,4-ジフルオロー4-ボラー3a,4a-ジアザーs-インダセンを使用した以外は、実施例1に記載の方法により有機電界発光索子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、緑色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第2表に示した。

【表4】

第2表

有权证界		口流密度
発光 算子 ,	(c d/m²)	(mA/cm^2)
実施例 2	2260	6 0
実施例 3	2240	5 4
実趋例 4	2230	6 1
実趋例 5	2260	5 6
実趋例 6	2320	5 7
実趋例 7	2250	5 5
吳趙例 8	2300	5 6
突防例 9	2230	5 9
実趋例10	2290	5 5
実施例11	2350	5 5
奥施例12	2300	5 6
実施例13	2260	6 0
実為例14	2320	6 1
比较例 1	1170	8 2
比效例 2	1550	6 0

【0054】実施例15

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、IT〇透明電極上に、4,4'ービス[Nーフェ ニルーN-(3"-メチルフェニル)アミノ) ピフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリ ス(8-キノリノラート)アルミニウムと化合物(1-23) を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 n m/se c で50nmの厚さに共蒸着 (重量比100:1.0) し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラー ト)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/sec で50 n mの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにそ の上に、マグネシウムと銀を蒸着速度0.2nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰 極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸 着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電 界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加 したところ、 $58mA/cm^2$ の電流が流れた。輝度1950 c d/m² の赤橙色の発光が確認された。

【0055】実施例16

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ

らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、IT〇透明電極に、4,4'ービス[Nーフェニ ルーN-(3" -メチルフェニル) アミノ) ピフェニル を、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸着 し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムーμ ーオキソービス(2ーメチルー8ーキノリノラート)ア ルミニウムと化合物 (1-27) を、異なる蒸着源か ら、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに共蒸 着(重量比100:2.0)し、発光層とした。次に、 トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、蒸着速 度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注 入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を 蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を 作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま 実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気 下、12 Vの直流電圧を印加したところ、60 mA/c m^2 の電流が流れた。輝度 $2010cd/m^2$ の赤橙色 の発光が確認された。

【0056】実施例17

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。

まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス[N-フェ ニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕 ピフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラート) アルミニウ ムールーオキソービス(2,4ージメチルー8ーキノリ ノラート) アルミニウムと化合物(1-16)を、異な る蒸着源から、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの 厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、発光層とし た。次に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウム を、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着 し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシ ウムと銀を蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚 さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾 燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、61 mA/cm² の電流が流れた。輝度1970cd/m² の赤橙色の発光が確認された。

【0057】実施例18

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス[Nーフェ ニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ) ピフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリ ス (8-キノリノラート) アルミニウムと化合物 (1-29) を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/se c で50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0) し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さらにその 上に、マグネシウムと銀を蒸着速度O.2nm/sec で 200 nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極 とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着 槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界 発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加し たところ、58mA/cm² の電流が流れた。輝度19 50cd/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0058】実施例19

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'ービス[N-フェニルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ]ビフェニルを、蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、1.

1,4,4-テトラフェニルー1,3-ブタジエンを、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと化合物(1-1)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重量比100:4.0)し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、52mA/cm²の電流が流れた。輝度2270cd/m²の青色の発光が確認された。

【0059】実施例20

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダー に固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。 まず、ITO透明電極上に、4,4'ーピス〔Nーフェ ニルーN-(3"ーメチルフェニル)アミノ〕ピフェニ ルを、蒸着速度0.2nm/sec で75nmの厚さに蒸 着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、化合 物 (1-14)を、蒸着速度0.2 nm/sec で50 n mの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、 1, 3-ピス(5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾールー2'-イル〕ベンゼン を、蒸着速度0.2nm/sec で50nmの厚さに蒸着 し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシ ウムと銀を蒸着速度0.2 n m/sec で200 n mの厚 さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界 発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を 保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾 燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、49 mA/cm² の電流が流れた。輝度1990cd/m² の赤橙色の発光が確認された。

【0060】実施例21

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。まず、ITO透明電極上に、化合物(1-10)を、蒸着速度0.2nm/secで55nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビス〔5'ー(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル〕ベンゼンを、蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を蒸着速度

0.2 n m/sec で200 n mの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加したところ、68 m A/c·m²の電流が流れた。輝度1150 c d/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0061】実施例22

厚さ200nmのITO透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電板ト に、ポリーN-ビニルカルバゾール (重量平均分子量1 50000)、1, 1, 4, 4ーテトラフェニルー1, 3-ブタジエン(骨色の発光成分)、クマリン6〔"3 -(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノク マリン"(緑色の発光成分)〕、および化合物(1-5) を、それぞれ重量比100:5:3:2の割合で含 有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップ コート法により、400nmの発光層を形成した。次 に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板 ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減 圧した。さらに、発光層の上に、3-(4'-tert-ブ チルフェニル) -4-フェニル--5-(4"-ビフェ ニル)-1,2,4-トリアゾールを、蒸着速度0.2 nm/sec で20nmの厚さに蒸着した後、さらにその 上に、トリス (8-キノリノラート) アルミニウムを、 蒸着速度0.2nm/sec で30nmの厚さに蒸着し電 子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと 銀を蒸着速度0.2nm/sec で200nmの厚さに共 蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素 子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保った まま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲 気下、127の直流電圧を印加したところ、74mA/ c m² の電流が流れた。輝度1280 c d/m² の白色 の発光が確認された。

【0062】実施例23

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ボリーNービニルカルバゾール(重量平均分子量150000)、1、3ービス〔5'ー(pーtertーブチルフェニル)ー1、3、4ーオキサジアゾールー2'ーイル〕ベンゼンおよび化合物(1-35)を、それぞれ重量比100:30:3の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、300nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×10-6 Torr に減圧した。さらに、発

光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200 nmの厚さに共蒸着 (重量比10:1) して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、15 Vの直流電圧を印加したところ、76 mA/c m²の電流が流れた。 輝度1360 c d/m²の赤橙色の発光が確認された。 【0063】比較例3

実施例23において、発光層の形成に際して、化合物 (1-35)の代わりに、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエンを使用した以外は、実施例23に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界素子に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したところ、86mA/cm²の電流が流れた。輝度680cd/m²の骨色の発光が確認された。【0064】実施例24

厚さ200 n mの I T O透明電極 (陽極)を有するガラ ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超 音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上 に、ポリカーボネート(重量平均分子量50000)、 4, 4'ーピス [N-フェニル-N-(3"-メチルフ ェニル) アミノ) ビフェニル、ビス (2-メチル-8-キノリノラート) アルミニウムーμーオキソービス (2 -メチル-8-キノリノラート) アルミニウムおよび化 合物(1-7)を、それぞれ重量比100:40:6 0:1の割合で含有する3重量%ジクロロエタン溶液を 用いて、ディップコート法により、300nmの発光層 を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板を、 蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を3×1 O-6 Torr に減圧した。さらに、発光層の上に、マグネ シウムと銀を、蒸着速度0.2nm/sec で200nm の厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機 電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子 に、乾燥雰囲気下、15Vの直流電圧を印加したとこ ろ、66mA/cm² の電流が流れた。 輝度1070c d/m²の赤橙色の発光が確認された。

【0065】実施例25

ガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ガラス基板上に、化合物(1-1)を、蒸着速度0.2nm/secで100nmの厚さに蒸着した。その上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とした。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。その後、陰極上にスコッチテープを張り付けた後、スコッチテープを剥離したところ、陰極と共に、化合物(1-1)の薄膜もガラス基板から剥離し、陰極との密着力は良好であることが判明した。

【0066】比較例4

実施例25において、化合物 (1-1)の代わりに、1,3,5,7,8-ペンタメチルー4,4-ジフルオロー4-ボラー3a,4a-ジアザーsーインダセンを使用した以外は、実施例25に記載の方法により陰極を蒸着した薄膜を作製した。その後、陰極上にスコッチテープを張り付けた後、スコッチテープを剥離したところ、陰極と1,3,5,7,8-ペンタメチルー4,4ージフルオロー4ーボラー3a,4a-ジアザーsーインダセンの薄膜の間で剥離し、陰極との密着力は不良であることが判明した。

[0067]

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電 界発光素子を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の1例(A)の概略構造図である。

【図2】有機電界発光素子の1例(B)の概略構造図である。

【図3】有機電界発光素子の1例(C)の概略構造図である。

【図4】有機電界発光素子の1例(D)の概略構造図で

ある。

【図5】有機電界発光素子の1例(E)の概略構造図である。

【図6】有機電界発光素子の1例(F)の概略構造図である。

【図7】有機電界発光素子の1例(G)の概略構造図で ある

【図8】有機電界発光素子の1例(H)の概略構造図である。

【符号の説明】

1:基板

2:陽極

3:正孔注入輸送層

3 a:正孔注入輸送成分

4:発光層

4 a:発光成分

5:電子注入輸送層

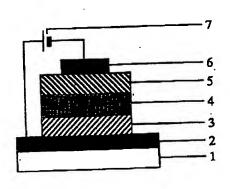
5":電子注入輸送層

5a:電子注入輸送成分

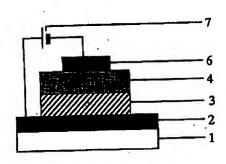
6:陰極

7:電源

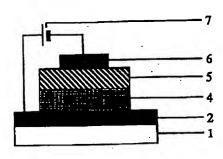
【図1】



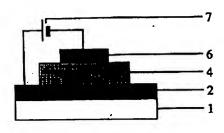
【図2】

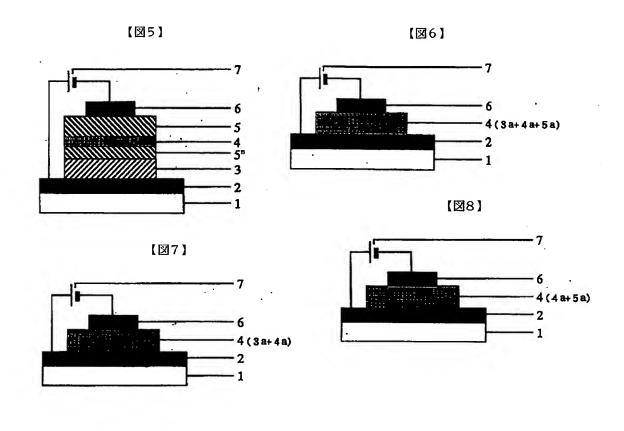


【図3】



[図4]





フロントページの続き

(72)発明者 塚原 宇 神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井 東圧化学株式会社内 (72) 発明者 詫摩 啓輔.

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

(72)発明者 中塚 正勝

神奈川県横浜市栄区笠間町1190番地 三井

東圧化学株式会社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)